BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 🏶 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

METAL YÜKLENMİŞ KARBON NANOTÜPLERIN NO SENSÖRÜ OLARAK KULLANILABILIRLIĞININ YOĞUNLUK FONKSIYONELİ TEORISI ILE iNCELENMESI

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Selin DEMİR

Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

KASIM 2019



BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ � FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

METAL YÜKLENMİŞ KARBON NANOTÜPLERİN NO SENSÖRÜ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN YOĞUNLUK FONKSİYONELİ TEORİSİİLE İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Selin DEMİR (171080502)

Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Ferdi FELLAH

KASIM 2019

BTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü'nün 171080502 numaralı Yüksek Lisans Öğrencisi Selin DEMİR, ilgili yönetmeliklerin belirlediği gerekli tüm şartları yerine getirdikten sonra hazırladığı "METAL YÜKLENMİŞ KARBON NANOTÜPLERİN NO SENSÖRÜ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN YOĞUNLUK FONKSİYONELİ TEORİSİ İLE İNCELENMESİ"başlıklı tezini aşağıda imzaları olan jüri önünde başarı ile sunmuştur.

Tez Danışmanı :	Prof. Dr. Mehmet Ferdi FELLAH Bursa Teknik Üniversitesi	
Jüri Üyeleri :	Doç. Dr. Oğuzhan İLGEN Kocaeli Üniversitesi	
	Dr. Öğr. Üyesi Derya ÜNLÜ Bursa Teknik Üniversitesi	

Savunma Tarihi : 5 Kasım 2019

 FBE Müdürü :
 Doç. Dr. Murat ERTAŞ

Bursa Teknik Üniversitesi

...../...../.....

İNTİHAL BEYANI

Bu tezde görsel, işitsel ve yazılı biçimde sunulan tüm bilgi ve sonuçların akademik ve etik kurallara uyularak tarafımdan elde edildiğini, tez içinde yer alan ancak bu çalışmaya özgü olmayan tüm sonuç ve bilgileri tezde kaynak göstererek belgelediğimi, aksinin ortaya çıkması durumunda her türlü yasal sonucu kabul ettiğimi beyan ederim.

Öğrencinin Adı Soyadı : Selin DEMİR

İmzası :

Canım Aileme,

ÖNSÖZ

Bu tez çalışmasının hazırlanmasında değerli bilgilerini her zaman benimle payşalaşan, bana her konuda sabırla ve büyük bir ilgiyle destek olan, yardım ve katkılarıyla beni yönlendiren, mesleki hayatımda da çalışma prensibini örnek alacağım çok saygıdeğer tez danışmanım Prof. Dr. Mehmet Ferdi FELLAH'a,

Sundukları altyapı ve çalışma imkanlarından dolayı, TÜBİTAK ULAKBİM Yüksek Başarımlı ve Grid Hesaplama Merkezi'ne ve Bursa Teknik Üniversitesi'ne,

Lisans ve lisansüstü çalışma sürecinde manevi desteğiyle yanımda olan çalışma arkadaşım Nazmiye SERİNÇAY'a,

Hayatımın her aşamasında bana destek olan, her zaman yanımda olan kıymetli annem Ayşe DEMİR'e, değerli babam Niyazi DEMİR'e, abim Onur DEMİR'e, ablam Selin DEMİR'E, bir tanemiz Miray Duru DEMİR'e ve sevgili nişanlım Mustafa Sefa VELİPAŞAOĞLU'na sonsuz sevgi, saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum.

KASIM 2019

Selin DEMİR

İÇİNDEKİLER

<u>Sayfa</u>

ÖNSÖZ	v
İÇİNDEKİLER	vi
KISALTMALAR	vii
SEMBOLLER	viii
CİZELGE LİSTESİ	ix
ŞEKİL LİSTESİ	X
1. GİRİŞ	1
2. GENEL BILGILER	
2.1 Karbon Nanotüpler	
2.1.1Karbon yapıları	
2.1.2 Karbon nanotüpler	7
2.1.2.1 Karbon nanotüplerin kristal yapısı	7
2.1.2.2 Karbon nanotüp çeşitleri	
2.1.2.3 Karbon nanotüplerin özellikleri	
2.1.2.4 Karbon nanotüplerin üretim yöntemleri	14
2.1.3 Literatür araştırması	
2.2 Azot Oksit	
2.3 Gaz Sensör Mekanizmaları	
2.3.1Yüzeye adsorbe edilmiş oksijen iyonları mekanizması	
2.3.2 Yük transfer mekanizması	
2.4 Hesaplamalı Kimya	
2.4.1 Moleküler mekanik yöntemler	
2.4.2 Moleküler dinamik yöntemler	
2.4.3 Elektronik yapı yöntemleri	
2.4.3.1 Yarı-deneysel yöntemler	
2.4.3.2 Ab-İnitio yöntemler	
2.4.3.3 Yoğunluk fonksiyoneli teorisi (dft) yöntemleri	
3.YÜZEY MODELİ VE YÖNTEM	
4.BULGULAR VE TARTIŞMA	
5. SONUÇ VE ÖNERİLER	
5.1 Sonuçlar	
5.2 Öneriler	
ÖZGEÇMİŞ	

KISALTMALAR

CC	:	Yığın teorisi
CI	:	Konfigürasyon etkileşimi
CNTFET	:	Carbon nanotube field-effect transistor
CVD	:	Kimyasal buhar biriktirme
ÇDKNT	:	Çok Duvarlı Karbon Nanotüp
DFT	:	Density functional theory
DOS	:	Density of states-durum yoğunluğu
EG	:	Equilibrium geometry
ESP	:	Elektrostatik potansiyel
Freq	:	Frekans anahtar kelimesi
HAADF	:	Yüksek açılı açısal karanlık alan
HF	:	Hartree-Fock
HLG	:	HOMO ile LUMO arasındaki enerji boşluğu
KNT	:	Karbon Nanotüp
MAADF	:	Orta açılı halka şeklindeki karanlık alan taramalı transmisyon
		elektron mikroskopisi
MP	:	Møller-Plesset Perturbation Theory
NBO	:	Natural Bond Orbital
Ni- TDKNT	:	Nikel katkılı tek duvarlı karbon nanotüp
Pd –TDKNT	:	Paladyum katkılı tek duvarlı karbon nanotüp
Pt–TDKNT	:	Platin katkılı tek duvarlı karbon nanotüp
SCR	:	Seçici Katalitik İndirgeme
\mathbf{SM}	:	Spin Multiplicity
SPE	:	Single point energy
STEM	:	Taramalı-geçirimli elektron mikroskobu
TDKNT	:	Tek Duvarlı Karbon Nanotüp
TEM	:	Geçirimli elektron mikroskobu
VASP	:	Vienna ab initio simulation package
ZPE	:	Zero Point Energy Correction

SEMBOLLER

ή :	:	Kimyasal sertlik
Α	:	Elektron ilgisi
S	:	Kimyasal yumuşaklık
Y	:	Young modülü
ΔG	:	Relatif gibbs serbest enerji
ΔΕ	:	Relatif enerji
ΔH	:	Relatif entalpi
η	:	Kimyasal sertlik
μ	:	Kimyasal potansiyel
χ	:	Elektronegatiflik
ω	:	Elektrofiliklik
I	:	İyonizasyon potansiyeli
X	:	Elektronegatiflik

ÇİZELGE LİSTESİ

<u>Sayfa</u>

Çizelge 2.1 : Karbon bazlı malzemelerin fizikokimyasal özellikleri
Çizelge 2.2 : Grafen tabakasının (n, m) rulo oryantasyonuna bağlı olarak, tek duvarlı karbon
nanotüplerin teorik elektronik iletkenliğ i8
Çizelge 2.3 : KNT üretim yöntemleri 16
Çizelge 2.4 : NO adsorpsiyonu üzerine yapılmış teorik ve deneysel çalışmalar
!Unexpected End of Formula
Çizelge 4.1 : Metal katkılı KNT üzerine adsorbe edilip optimize edilen azot oksit için yapısal
parametreler
Çizelge 4.2 : Metal atomları ile en yakın üç C atomunun adsorpsiyon öncesi ve sonrası açı değerleri.
Çizelge 4.3 : Metal yüklü KNT yapılarının sahip oldukları toplam termal enerji, termal entalpi ve
Gibbs serbest enerjisi
Çizelge 4.4 : Metal katkılı KNT üzerine adsorbe edilip optimize edilen azot oksit için enerji değerleri.
Çizelge 4.5 : Mulliken popülasyon analizi
Cizelge 4.6 : NBO analizi
Cizelge 4.7 : Ni, Pd, Pt katkılı TDKNT(6,0) yapıları için HOMO ve LUMO enerjisi, kimyasal sertlik,
kimyasal potansiyel, elektronegatiflik, HLG (HOMO ile LUMO arasındaki enerji boşluğu)
değerleri

ŞEKİL LİSTESİ

<u>Sayfa</u>

Sekil 2.1 : Karbon elementi	
Sekil 2.2 : Karbon hibridizasyonu a) l	Dört sp3 orbitali b) Üç sp2 orbitali c) İki sp orbitali
Şekil 2.3 : a) fulleren, b) nanotüp, c) g	grafit, d) grafen, e)elmas yapıları6
Şekil 2.4 : Grafen yapısı üzerinde biri	m hücre vektörü ve kiral vektör gösterim i7
Şekil 2.5 : Elektriksel iletkenliklerine	göre sınıflandırılmış periyodik cetvel
Şekil 2.6 : Tek ve çok duvarlı karbon	nanotüpler
Şekil 2.7: TDKNT a) SEM görüntüsü	, b) TEM görüntüsü11
Sekil 2.8 : CDKNT a) SEM görüntüsi	i, b) TEM görüntüsü11
Şekil 2.9 : Grafen yapısına yüklenmiş)/MAADF (Orta açılı halka şek mikroskopisi) görüntüsü, b) rer yapısının yandan görünüsü	P atomu, a) STEM (Taramalı-Geçirimli Elektron Mikroskobu lindeki karanlık alan taramalı transmisyon elektron kli STEM/MAADF görüntü, c) model yapısı, d) model 18
Şekil 2.10 : Fe, Pd, Co, Mn metallerir	in KNT üzerinde tekli atom şeklinde a) yüksek çözünürlüklü
TEM b) STEM /MAADF görün	tüleri18
Şekil 2.11 : Azot oksit (NO) gaussvie	w görüntüsü
Şekil 2.12 : Farklı metal nano malzen	eler ile dekore edilmiş CNTFET cihazı görüntüsü
Şekil 2.13 : Hesapsal kimya ile elde e	dilebilecek veriler
Şekil 2.14 : Hesaplamalı kimya çözür	n yöntemleri
Şekil 3.1 : (6,0) karbon nanotüp yapıs	1
Şekil 3.2 : a) Ni, b) Pd, c) Pt metal ka	tkılı (6,0) KNT yapıları34
Şekil 4.1 : NO molekülü IR spektrum	u
Şekil 4.2 : Adsorpsiyon öncesi; Ni ka molekülü, b) oksijen tarafından tarafından yaklaştırılmış NO mo katkılı KNT üzerine e) nitrojen yaklaştırılmış NO molekülü	tkılı KNT üzerine a) nitrojen tarafından yaklaştırılmış NO yaklaştırılmış NO molekülü, Pd katkılı KNT üzerine c) nitrojen olekülü, d) oksijen tarafından yaklaştırılmış NO molekülü, Pt tarafından yaklaştırılmış NO molekülü, f) oksijen tarafından 40
Şekil 4.3 : Adsorpsiyon sonrası; Ni ka molekülü, b) oksijen tarafından tarafından yaklaştırılmış NO mo katkılı KNT üzerine e) nitrojen	ıtkılı KNT üzerine a) nitrojen tarafından yaklaştırılmış NO yaklaştırılmış NO molekülü, Pd katkılı KNT üzerine c) nitrojen olekülü, d) oksijen tarafından yaklaştırılmış NO molekülü, Pt tarafından yaklaştırılmış NO molekülü, f) oksijen tarafından
yaklaştırılmış NO molekülü	
Şekil 4.4 : Ni-TDKNT üzerinde NO	adsorpsiyonu öncesi ve sonrası, alfa ve beta olarak HOMO-
LUMO gösterimleri Şekil 4.5 : Pd-TDKNT üzerinde NO a	dsorpsiyonu öncesi ve sonrası, alfa ve beta olarak HOMO-
LUMO gösterimleri Sekil 4.6 : TDKNT üzerinde NO adso	
gösterimleri	
Şekil 4.7 : Ni-TDKNT a) adsorpsiyon d) adsorpsiyo sonrası, Pt-TDKN	öncesi b) adsorpsiyo sonrası, Pd-TDKNT c) adsorpsiyon öncesi T e) adsorpsiyon öncesi f) adsorpsiyo sonrası DOS grafikleri.
Şekil 4.8 : Ni-TDKNT a) adsorpsiyon d) adsorpsiyo sonrası, Pt-TDKN	

METAL YÜKLENMİŞ KARBON NANOTÜPLERİN NO SENSÖRÜ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN YOĞUNLUK FONKSİYONELİ TEORİSİ İLE İNCELENMESİ

ÖZET

Azot oksit (NO) ve azot dioksit (NO₂) birlikte azot oksitler (NO_X) olarak adlandırılır. NO_x'in büyük oranı azot oksit (NO) halinde olup, daha sonra atmosfer sıcaklığında NO₂ kolayca oksitlenebilir. NO renksiz, kokusuz bir gazdır; bitki, insan ve hayvanların solunum sistemine zararlıdır veya canlı vücudundaki oksijeni tüketebilirler. Bu sebepleNO'nun tespiti ve NO konsantrasyonunu en aza indirmek oldukça önemlidir. NO sensörlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Ancak, geleneksel NO sensörlerinin yüksek çalışma sıcaklığı ve düşük algılama gibi birçok kusuru vardır.

1990'lı yılların başındaki keşfedilişlerinin ardından karbon nanotüpler ile ilgili üstün ve benzersiz özellikleri hakkında çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Hekzagonal sistemde bazal düzlemlerde C-C bağları oluşturulup (Grafen yapısı), bu bağların yuvarlatılıp silindirik şekil elde edilmesiyle oluşuriz.Düşük yoğunlukları, yüksek mukavemeti, yüksek akım taşıma kapasitesi, yüksek ısı iletimi, yüksek sıcaklık kararlılığı, insan saçından 10.000 kez daha ince yapısı, mekanik olarak sağlamlığı, kovalent bağ ile bağlı yapıları, farklı yarıçaplarda çok katlı olabilen ve çok kararlı yapıları sayesinde pek çok kullanım alanları vardır. Son yıllarda, karbon nanotüp gaz sensörleri olarak, yüksek hassasiyet, hızlı yanıt, küçük boyut ve düşük çalışma yetenekleri sayesinde sıcaklığı gibi mükemmel algılama yoğun ilgi görmüştür.Kullanılan nano malzemeler son yıllarda elektrikli cihazlardaki hassasiyeti yüksek miktarda arttırmış ve tek molekül algılama seviyesine getirebilmiştir.

NO adsorpsiyonu (NO sensör çalışması) çeşitli adsorbanlar üzerinde deneysel ya da teorik çalışılmış olmasına rağmen metal yüklenmiş karbon nanotüpler üzerinde çok sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır. Bu tezçalışmasının amacıNİ, Pd, Pt yüklenmiş (6,0) tek duvarlı karbon nanotüplerinoda sıcaklığında NO sensörü olarak, dünyada yaygın bir şekilde çalışılmaların yapıldığı kuantum kimyasal metotlardan biri olan DFT (Density Functional Theory - Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi) yardımıyla tespit edilerek incelenmesi ile ülkemizin bilim dünyasına ve literatürüne bir katkı vermesi ve olası deneysel çalışmalara öncülük etmesine olanak sağlayacak araştırmalara yöneliktir.

Tez kapsamında yapılan bu kuantum kimyasal hesaplarda WB97XD/6-31G(d,p) metodu kullanılmıştır. Yapı (cluster) modellemesi ile tasarlanan karbon nanotüp yapıları üzerindeki bir karbon atomunun yerine metal yükleme işlemleri yapılmıştır. NO molekülü karbon nanotüp üzerindeki metal atomunun üzerine hem nitrojen hem de oksijen tarafından yerleştirilerek kuantum kimyasal hesaplamalar

yapılmıştır.Sistemin tercih edeceği minimum enerjilikonfigürasyon, Ni-TDKNT için O tarafından yakınlaşan NO molekülü, Pd –TDKNT ve Pt-TDKNT yapıları için ise N tarafından yakınlaşan NO molekülüdür. Bu yapılar için enerji değerleri ve yapısal parametreler kuantum kimyasal hesaplar ileNO adsorpsiyonu öncesi ve sonrası olarak hesaplanmış ve bu yapılar için karşılaştırılmıştır. Adsorpsiyon enerji değerleri sırası ile Ni-CNT, Pd-CNT ve Pd-CNT yapılarında sırasıyla -57,0, -82,6, -82,1 kcal/mol olarak hesaplanmıştır.Kimyasal kararlılık hakkında önemli bilgi veren HOMO ve LUMO enerji boşluğu (HLG) sadece Pt katkılı TDKNT yapısında NO adsorpsiyonu sonrası azalmıştır.

Sonuç olarak, Pt katkılı (6,0) TDKNT yapısının oda sıcaklığında azot oksit algılama potansiyeli vardır.

Anahtar Kelimeler: Karbon nanotüp, NO, Metal Yükleme, Sensör, Adsorpsiyon, Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi.

A DENSITY FUNCTIONAL THEORY (DFT) STUDY OF METAL DOPED CARBON NANOTUBES AS NO SENSOR

SUMMARY

Nitric oxide (NO) and nitrogen dioxide (NO₂) are referred to as nitrogen oxides(NO_X). The large proportion of nitrogen oxides exist as nitric oxide but also, NO is easily oxidized to NO₂at atmospheric temperature. NO is a colorless, odourless gas; harmful to the respiratory system of plants, humans and animals or it can be consume oxygen in living body. Therefore, it is very important to minimize NO concentration. Some studies had carried out to develop NO sensors. However, conventional NO sensors have many defects such as high operating temperature and low detection.

There are many research on carbon nanotubes about their superior and unique characteristics after the discoveries of the early 1990s.C-C bonds (graphenestructure) are formed and these bonds are rounded after that a cylindrical shape are obtained in (basal) plane of hexagonal system. They have low density, high strength, high current carrying capacity, high heat conduction, high temperature stability, 10,000 times thinner structure than human hair, mechanical strength, covalent bonded structures, multi-layer structures with different radius and very stable structures so there are many application areas. In recent years, carbon nanotube has attracted great attention as gas sensors thanks to excellent sensing capabilities such as high sensitive, quick response, low operating temperature and small size. The nano materials used have increased the sensitivity of electrical devices in recent years and they have been able to increase the level of single molecule detection.

Although NO adsorption (NO sensor) has been studied on various adsorbents experimentally or theoretical, there are a very few studies on metal doped carbon nanotubes. The aim of the thesis is to produce the carbon nanotubes (6.0) doped with Ni, Pd, Pt metals at room temperature as NO sensor by using DFT (Density Functional Theory), which is one of the quantum chemical methods that widely used in the world to contribute the scientific world and literature of our country and to lead the possible experimental studies.

WB97XD/6-31G(d, p) method will be used for quantum chemical calculations in this thesis. Carbon nanotube will be designed with cluster modeling and the selected metal atom was replaced by removing one carbon atom. The NO molecule with both Nitrogen and oxygen sides will be placed on the metal atom of the carbon nanotube.

Minimum energy configuration preferred by the system, Oxygen sides configuration is used for Ni-SWCNT. Nitrogen sides configuration is used for Pd-SWCNT and Pt-SWCNT. On these clusters, structural properties and energy values obtained by quantum chemical methods calculations for the initial configuration and after NO adsorption.The results obtained were compared. Adsorption energy values were calculated for Ni-CNT, Pd-CNT and Pd-CNT cluster as -57,0, -82,6, -82,1 kcal / mol, respectively.

HOMO and LUMO energy gap, which gives important information about chemical stability, decreased only in Pt doped SWCNT structure after NO adsorption.

As a result, Pt doped (6,0) TDKNT has the potential to detect nitrogen oxide at room temperature.

Keywords: Carbon Nanotube, NO, Metal Doping, Sensor, Adsorption, Density Functional Theory.

1. GİRİŞ

Azot oksitler (nitrojen oksitler -NO_X), azot ve oksijenden oluşan bileşiklerdir. En yaygın ve tehlikeli iki azot oksidi, azot oksit ve azot dioksittir. Azot oksit (Nitrik oksit veya azot monoksit), NO formülüne sahip renksiz bir gazdır. Çalışmalar, nitrojen oksitlerin (NO_X), insanların zatürree ve bronşit ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarına karşı direncini düşürmenin yanı sıra akciğer tahrişine neden olabileceğini göstermiştir. Güneş ışığında, NO_x bir fotokimyasal sis oluşturabilecek reaksiyona girebilir. Hidrokarbonlar da mevcutsa, NOx'e benzer sağlık etkisi olan ozon üretilebilir. Şehir bölgelerinde daha yüksek NO_X konsantrasyonları bulunsa da, kırsal alanlarda da yüksek olma eğiliminde olduğu ozon konsantrasyonlarının, mahsul verimi azalttığı görülmektedir. Emisyon oranı yakıttan yakıta ve sektörden sektöre değişmekle birlikte, tüm yakıtlardan emisyonlar meydana gelir. Taşımacılık kaynakları ve enerji ve imalat sanayileri en önemli kaynaklardır. Son yıllarda NO_X emisyonlarına katkıları karayolu taşımacılığı için %32, diğer taşımacılık türleri için %21 (arazi araçları ve mobil makineler dahil), elektrik santrallerinden ve diğer enerji üreticilerinden %21 ve diğer sanayi sitelerinden %7 idi. Karayolu taşımacılığı emisyonlarının çoğu dizel araçlardan kaynaklanmaktadır. Yanma kaynaklarından kaynaklanan emisyonların tahmini karmaşıktır, azot ya yakıttan (katı yakıtlar söz konusu olduğunda) ya da atmosferik azottan kaynaklanabilir Emisyon, yanma koşullarına, özellikle de büyük ölçüde değişebilen sıcaklık ve hava oranına bağlıdır.

1990'dan beri, genel NO_X emisyonları %72 oranında azalmıştır. Bu düşüş, yukarıda belirtilen tüm geniş sektörlerden kaynaklanan emisyonlardaki azalma nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Karayolu taşımacılığından kaynaklanan emisyonlar %77 oranında düştü. Katalitik konvertörlerin ve daha katı düzenlemelerin getirilmesinden dolayı (Euro Standartları gibi) bu düşüş meydana geldi. Diğer ulaştırma kaynaklarından kaynaklanan emisyonlar, tarımsal ve diğer arazi taşıtlarından kaynaklanan nakliye ile yakılan akaryakıtlardaki emisyonlardaki azalma nedeniyle %52 düştü. Büyük ölçüde santrallerde kömür kullanımının azalması, bu santrallerden kaynaklanan emisyonların daha iyi kontrolü, endüstriyel yakıt olarak yakıt

kullanımının azaltılması ve çimento fırınlarından kaynaklanan emisyonların azaltılması nedeniyle enerji ve imalat sanayinden kaynaklanan emisyonlar sırasıyla % 78 ve % 63 oranında düşmüştür [1]. Ancak bu düşme oranları hayati önem taşıyan bu kirleticiler için yeterli seviyede olmayıp, hala insan sağlığını tehdit etmeye devam etmektedirler. Hava kirliliği ile ilgili önemli anlaşmalardan biri olan Göteborg Protokolü 2010'da 2020'ye kadar dört kirletici madde için kükürt (SO₂), azot oksitler (NO_X), uçucu organik bileşikler (VOC'ler) ve amonyak (NH₃), ulusal emisyon tavanları belirlemektedir [2]. Çok yüksek seviyelerde olumsuz sağlık etkisine sebep olan bu parçacıklar için bağlayıcı sınır değerleri içeren bir yönetmelik henüz Türkiye'de kabul edilmemiştir. Temiz Hava Girişimi'nin çağrısı doğrultusunda, hava kirliliği seviyesini limitlerin altına indirmesi için gerekli önlemlerin hızla alması gerekmektedir.

1990'lı yılların başındaki keşfedilişlerinin ardından karbon nanotüpler ile ilgili üstün ve benzersiz özellikleri hakkında çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Son yıllarda, karbon nanotüp gaz sensörleri olarak, yüksek hassasiyet, hızlı yanıt, küçük boyut ve düşük çalışma sıcaklığı gibi mükemmel algılama yetenekleri sayesinde yoğun ilgi görmüştür. NO renksiz, kokusuz bir gazdır; bitki, insan ve hayvanların solunum sistemine zararlıdır veya canlı vücudundaki oksijeni tüketebilirler. Bu sebeple NO konsantrasyonunu en aza indirmek oldukça önemlidir. NO sensörlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Ancak, geleneksel NO sensörlerinin yüksek çalışma sıcaklığı ve düşük algılama gibi birçok kusuru vardır. NO adsorpsiyonu çeşitli adsorbanlar üzerinde deneysel ya da teorik olarak çalışılmış olmasına rağmen metal yüklenmiş karbon nanotüpler üzerinde çok sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır. Yapılan tez çalışmasının amacı Ni, Pd ve Pt metallerinin yüklendiği (6,0) tek duvarlı karbon nanotüplerinin oda sıcaklığında NO sensörü olarak,dünyada yaygın bir şekilde çalışılmaların yapıldığı kuantum kimyasal metotlardan biri olan DFT (Density Functional Theory - Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi) yardımıyla tespit edilerek incelenmesidir.

2. GENEL BİLGİLER

2.1 Karbon Nanotüpler

2.1.1Karbon yapıları

Karbon adının kökeni Latince kömür anlamına gelen 'carbo' kelimesinden gelmektedir. Canlılarıntemel taşı olarak kabul edilen karbon bütün canlı maddelerde bulunmaktadır.

Hayvanları ve bitkileri oluşturan yapıların çoğu üç temel molekülden oluşur; amino asitler, karbonhidratlar ve lipitler (yağ asitleri) ve bu malzemelerin tümü karbon içerir [3,4].

Doğada birçok alanda ve yaygın olarak bulunan karbon, yediğimiz yiyeceklerin, giydiğimiz kıyafetlerin, kullandığımız kozmetiklerin ve petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtların ana elementidir. Sonuç olarak, karbon (C), doğadaki en çok bulunan altıncı element ve Dünya'nın kabuğundaki kütle sırasındaki 19. elementtir.



Şekil 2.1 : Karbon elementi.

Atom numarası (Z) ve elektron sayısı 6, atom ağırlığı 12 olan karbon elementinin periyodik tablodan alınan görüntüsü Şekil 2.1'dedir. Periyodik tablonun 4A grubunda yer alan ilk element karbon atomu, ametal bir elementtir.Karbonun sınıflandırma şeması, karbondaki kimyasal bağların çeşidine dayanır ve her değerlik durumu, belirli bir basit maddenin formuna karşılık gelir. Karbon Şekil 2.2'degörüldüğü üzere, atomik orbitallerin sp3, sp2 ve spl hibridizasyonuna karşılık gelen üç bağlanma durumunda bulunabilir[5]. 6 adet elektron bulundurmasından dolayı karbon atomunun eşsiz özellikleri vardır. Bu sayede çok çeşitli fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip karbon atomlarından oluşan malzeme bulunmaktadır.



Şekil 2.2 : Karbon hibridizasyonu a) Dört sp3 orbitali b) Üç sp2 orbitali c) İki sp orbitali.

Karbon atomu karbon atomu ya da diğer atomlarla tekli, ikili ve üçlü bağ yapabilir. C-C kovalent bağların kuvvetli olmasından dolayı karbon atomları uzun karbon zincirleri oluşturabilirler. Bu zincirler, dallanabilir ve halka oluşturabilir.

Halkalar da kendi içlerinde, üç, dört, beş, altı ya da daha çok karbon atomundan oluşan çokgenler oluşturarak pek çok çeşit bulundurmaktadır. Kararlı halka bileşikler ve uzun zincirler oluşturma yeteneğine sahip olması karbon atomunu organiklerin ana elementi yapmıştır.

Oluşan kovalent bağların yapısı karbon allotroplarının çeşitli kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirler. Saf karbon bazlı materyaller sadece yaygın olarak bilinen elmas ve grafit allotropları olarak değil, aynı zamanda fullerenler, karbon nanotüpler (KNT''ler) ve grafen gibi daha egzotik varlıklar olarak da mevcuttur; bu son allotroplar nanoteknolojide kendilerini önemli materyaller olarak kanıtlamışlardır[6]. Allotroplar, bir elementin atomlarının farklı bir şekilde birbirine bağlanarak oluşan ve doğal haliyle bulunan formlarıdır.

Allotroplar, bir elementin farklı yapısal modifikasyonlarıdır ve her biri farklı fiziksel ve kimyasal özellikler gösterir. Sayısız karbon formu arasından en iyi bilinen karbonun beş allatropu sırasıyla fulleren, nanotüp, grafit, grafen, elmas fizikokimyasal özellikleriyle çizelge2.1'de gösterilmiştir.

Özellikler	Boyut					
	0B	1B	2B	2B	3B	
İzomer	Fulleren	Nanotüp	Grafit	Grafen	Elmas	
Bağ Şekli	sp ²	sp ² (sp ¹)	sp ²	p ²	sp ³	
Yoğunluk(g/cm3)	1,72	1,2-2,0	2,26	>1,0	3,515	
Bağ Uzunluğu(A0)	1,40(C=C)	1,44(C=C)	1,42(C=C)	1,42(C=C)	1,54(C-C)	
Elektronik Özellikleri	Yarı iletken Eg=1,9 eV	Metal veya yarı iletken	Yarı metal(met alimsi)	Yarı iletken	Yalıtkan Eg=5,47 eV	

Cizelge 2.1 : Karbon bazlı malzemelerin fizikokimyasal özellikleri.

Fulleren yapısında da bulunan karbon atomları sp² hibritlenir. Yarıiletken özelliktedir. İçi boş bir kürenin şeklini üretmek üzere spesifik bir şekilde etkileşime giren hem altıgen hem de beşgen karbon halkalardan oluşur.

Karbon nanotüp yapısında bulunan karbon atomları sp² hibritlenir. Karbon nanotüpler (KNT'ler) silindiriktir ve yapısal olarak fullerene benzemektedir ve her ikisi de karbon halkalardan (altıgen, beşgen ve heptagonal) oluşur. Tek duvarlı nanotüpler (TDKNT) ve çok duvarlı nanotüpler (ÇDKNT) olarak sınıflandırılır.

Grafit yapısında bulunan karbon atomları sp² hibritlenir ve birbirine hexagonal biçiminde kovalent bağ ile bağlanmasıyla oluşmuştur. Bu bağlanma şekli grafite kaygan, opak, elektriksel olarak iletkenlik ve yumuşak olma özelliklerine sahip olmasına sebep olmuştur.

Grafen yapısında da bulunan karbon atomları sp² hibritlenir. Bal peteği örgüsü adı verilen düzenli altıgen bir düzende düzenlenmiş, tek atom kalınlığında karbon atomlarıdır [7,8]. Ayrıca, grafen en kararlı iki boyutlu karbon malzemesidir. Grafen, yüksek elektriksel iletkenlik, yüksek dayanıklılık, daha büyük yüzey alanı ve kimyasal ve termal kararlılık dahil olmak üzere olağanüstü kimyasal ve fiziksel özelliklere sahiptir.Elmas yapısında bulunan karbon atomları sp³ hibritlenir ve

birbirine tetrahedral biçiminde bağlanmasıyla oluşmuştur. Her bir karbon atomları kendilerine komşu olan dört karbon atomuna bağlanmıştır. Bu kristal yapı elmasa bilinen en sert doğal madde olma özelliğini kazandırmıştır. Elektriksel yalıtkan ve optik saydımlığa sahip olup, yüksek ısı iletme özelliğine sahiptir[9]. Karbonun allatrop yapıları şekil 2.3'te gösterilmiştir.



Şekil 2.3 : Karbonun allatrop yapıları a) fulleren, b) nanotüp, c) grafit, d) grafen, e)elmas.

2.1.2 Karbon nanotüpler

Nanoteknoloji malzemelerin özelliklerini iyileştirmek amacıyla mikro teknolojiden daha küçük, atomik ölçekte gerçekleştirilen işleme teknolojisidir. Bir boyutu 100 nm'den küçük olan maddesel sistemlere nanomalzeme denir.Model sistem olarak karbon nanotüpler, nanoteknoloji için önemli bir malzemedir.

Karbon nanotüpler, karbon atomlarından oluşan tüp yapısında nanometre ölçeğinde çapa sahip malzemelerdir. Hekzagonal sistemde grafen düzlemlerinden türetilen karbon nanotüpler, grafenin silindir biçiminde yuvarlatılmasıyla oluşur. Farlı kalınlıkta, spiral tipte ve uzunlukta ve çok katmanlı olmak üzere çok çeşitli yapılardır.Çapları birkaç nanometre veya 25-30 nanometre arasında, boyları ise genelde belirsiz olup mikron civarındadır. Uzunluk-çap oranını 1.000.000'dan fazla olan bir nanoyapıya sahip olan karbon allotroplardır [10]. Elektriksel özellikleri geometrisine göre değişerek iletken ya da yarıiletkenlik özelliği gösterebilirler.

2.1.2.1 Karbon nanotüplerin kristal yapısı

Silindir yapısında olan TDKNT'leri oluşturan grafen katmanın yönlenmesine göre nanotüplerin kristal yapısı üç çeşittir. Zigzag, koltuk ve kiral nanotüpler olarak altıgen paketlenmiş halatlar olarak elde edilirler.Bu çeşitleritanımlamada kiral vektör kullanılır. Kiral vektör,taban vektörleri ile aşağıdaki denklem şeklinde oluşturulur [11,12]. Şekil 2.4'te gösterilmiştir.

$$C = na + ma \tag{2.1}$$

T harfi ile gösterilen birim hücre vektörü kiral vektör ile 90 derecelik açı yapacak şekilde aynı noktadan başlayarak çizilir [13].



Şekil 2.4 : Grafen yapısı üzerinde birim hücre vektörü ve kiral vektör gösterimi.

Nanotüp yapısını belirlemede kiral vektör özgün bir rol aldığı için KNT'ler, (n,m) olarak adlandırılırlar. Çizelge 2.2'de karbon nanotüp formlarının kiral açı vektörüne göre zigzag, koltuk ve kiral formlarında olan karbon nanotüpler ve bu formlardaki elektriksel iletkenlik arasındaki bağlantı gösterilmiştir [14-18].

(n,m)	Kiral açı	TDKNT formları	Elektriksel iletkenlik
(n, 0) zigzag	$ heta=0^{\mathrm{o}}$		n, 3'ün katı olduğu zaman yarımetalik; diğer durumlarda yarı iletken
(n, n) koltuk	$\theta^{\mathrm{o}}=30^{\mathrm{o}}$		metalik
(n, m) $m \neq 0$, & $m \neq n$ kiral	0°<θ< 30°		(2n + m) / 3, bir tam sayı olduğu zaman metalik; diğer durumlarda yarı iletken

Çizelge 2.2 : Grafen tabakasının (n, m) rulo oryantasyonuna bağlı olarak, tek duvarlı karbon nanotüplerin teorik elektronik iletkenliği.

Bu özelliklerin geniş bir skalada periyodik cetvel üzerinde gösterimi şekil 2.5'te çizilmiştir [19].



Şekil 2.5 : Elektriksel iletkenliklerine göre sınıflandırılmış periyodik cetvel.

2.1.2.2 Karbon nanotüp çeşitleri

Karbon Nanotüpler, Şekil 2.6'da gösterildiği gibi tek duvarlı karbon nanotüpler (TDKNT) ve çok duvarlı (ÇDKNT) olmak üzere iki ana formdan oluşmaktadır. TDKNT, tek yüzeyli karbon nanotüplerdir ve özellikle elektronik özelliklerden yararlanmak için kiralite özelliklerinde çeşitlilik gösteren TDKNT kullanmanız gerekir.

ÇDKNT ise çok yüzeyli malzemelerdir ve özel elektronik özelliklerini kaybedebilirler. Tüm kiral tüplerin ortalama etkisini göstereceklerdir. Bu nedenle bunların mekanik ve termodinamik özelliklerde kullanımı iyi olacaktır.



Şekil 2.6 : Tek ve çok duvarlı karbon nanotüpler.

2.1.2.2.1Tek duvarlı karbon nanotüpler (TDKNT'ler)

Tek duvarlı karbon nanotüpler, sentezlendikleri sıcaklığa bağlı olarak, çapı 0.4 ila 2 nm arasında olan tek bir silindirik karbon katmanından oluşur.Büyüme sıcaklığı ne kadar yüksek olursa, KNT'lerin çapı da o kadar büyüktür [20].

TDKNT'ler çoğu zaman Van der Waals bağları ile birbirine tutunan, sayıları 100-500 arasında değişen TDKNT demetler şeklinde bulunurlar. Bu karbon nanotüp çeşidi daha esnek bir yapıya sahiptir. Çok duvarlı karbon nanotüplere göre daha yüksek yüzey alanına sahiptir ve Molekül yükleme kapasitesi bü sebeple daha yüksektir.

Koltuk, zigzag ve kiral çeşitleriyle birlikte farklı elektronik özelliklere sahip TDKNT yapılarının TEM cihazı ile görüntüleri elde edilir.Metalik, yarı metalik, yarı iletken özellikleri farklı çaplara ve sarmal düzenlemelere göre farklılık gösterir. Bu yapıların bükülürken kırılma riski daha az ve daha esnek yapılanmaya sahiptir [21- 24]. TDKNT'lerin SEM ve TEM görüntüleri şekil 2.7'de gösterilmiştir [25,26].



Şekil 2.7 : TDKNT a) SEM görüntüsü, b) TEM görüntüsü.

2.1.2.2.2. Çok duvarlı karbon nanotüpler (ÇDKNT'ler)

Tek duvarlı karbon nanotüplerden daha değişik özelliklere sahip bu yapılar, tek duvarlı karbon nanotüplerin iç içe geçmesiyle oluşan nanotüplerdir.

ÇDKNT'lerin dış çapı 2-100 nm arasında değişirken, iç çap 0,4-5 nm arasındadır ve uzunlukları bir ila birkaç mikrometre arasındadır [10]. Kuramsal hesaplamalarla ÇDKNT'leri oluşturan grafen duvarlarının birbirlerine olan mesafeni 0.339 nm olarak elde edilmiştir [27]. ÇDNT'lerde duvarlar arası uzaklıkları TEM ve XRD analizlerinde ise 0,34 ila 0,39 nm aralığında bulunmuştur.Yapılan hesaplamalar ÇDNT'lerde duvarların birbiriyle olan etkileşimlerin çok fazla olmadığını ve bu sebeple öteleme ve dönme ve hareketleri birbirlerinden etkilenmeden yapabileceğine işaret etmektedir [28-30]. ÇDKNT'lerin SEM ve TEM görüntüleri şekil 2.8'de sunulmuştur [31,32].

a)







Şekil 2.8 : ÇDKNT a) SEM görüntüsü, b) TEM görüntüsü.

2.1.2.3 Karbon nanotüplerin özellikleri

2.1.2.3.1 Karbon nanotüplerin mekanik özellikleri

Nanotüplerin nano ölçekli cihazlarda veya kompozit malzemelerde en güçlü veya en sert elemanlar olarak kullanılması, bu alandaki araştırmalar için güçlü bir motivasyon olmaya devam etmektedir.

Karbon nanotüpler, eksenel bir yüke karşı çok yüksek sertlik veya rekor derecede yüksek verimli lineer elastik modüllere karşılık gelen küçük genlik bükülmesini gösterir. Daha büyük gerilme kuvvetlerinde ise (özellikle TDKNT'ler) nanotüpler içi boş kabuk benzeri yapı nedeniyle oluşumuna eğilimlidir ve esnek yapıları vardır.

Young'ın bir malzemenin çeşitli uygulamalar için yapısal bir eleman olarak kullanılmasına yönelik bilgi için başvurulan ilk adımdır. Uygulamada, yapısal mühendislik büyük ölçüde esneklik teorisine dayanmaktadır ve tasarım elastik sınırın altındaki baskılarla ilgilidir, güvenli yükler elastik sınırın yarısı veya daha azdır [33].Young modülü Y(elastisite modülü olarak da bilinen), katının birleşmesi ve dolayısıyla kurucu atomların kimyasal bağlanması ile doğrudan ilgilidir.Daha doğrusu, kovalent olarak bağlanmış bir katı durumunda, ideal bir kristalin katının elastik özelliklerini belirleyen parçacıklar arası fonksiyon olarak bir çift atomun potansiyel enerjisinin şeklidir [34].

Bir malzemenin Y'si doğrudan bağların sertliği ile ilgilidir ve Y α k/r₀ şeklinde yazabilir, burada k bağın yay sabitesi ve r₀ atomlar arası mesafedir.Atomlar arası mesafe farklı bağlar için fazla değişmez, fakat k değeri değişir.Metaller ve iyonik katılar için k, 15-100 N/m arasında değişir ve kovalent katılar için 20- 200 N/m arasında değişir. Karbon - karbon bağı için bilinen en yüksek değerler 500 - 1000 N/m arasındadır [35].

Nanotüplerin mekanik özellikleri oluşum yapılarına göre farklılıklar gösterebilmektedir.Günlük hayatta çeşitli kullanım alanlarında dayanıklılığı ile bilinen çelikten, nanotüplerin mekanik özellikleri daha yüksektir. Ayrıca Kevlar® lifleri olarak bilinen kurşungeçirmez malzeme imalatında kullanılar yapıdan nanotüplerin mekanik özellikleri önemli ölçüde yüksektir [36].

12

2.1.2.3.2 Karbon Nanotüplerin Elektriksel Özellikleri

Karbon nanotüpleri ilginç iletken malzemeler olarak ortaya çıkar. Çünkü elektron dalgaları birbirini güçlendirebilir veya yok edebilir.Tüm muhtemel elektron dalga boylarından veya düz grafit bir levhada mevcut olan kuantum durumlarından, bu grafit levha bir nanotüp şeklinde yuvarlandığında bu durumlar sadece küçük bir altküme oluşturur. Bu alt küme nanotüpün çevresine ve aynı zamanda nanotüpün kirallığına (bükülmesine) bağlıdır.

Nanotüplerin diğer birçok ilginç elektronik özelliği, alan emisyonlarıdır; elektrik alana yerleştirildiğinde uçlarından elektronlar yayarlar.Diğer birçok malzemeden yapılan elektrotlardan daha düşük voltajlarda elektronlar yayar ve güçlü karbon bağları nanotüplerin hasarsız olarak daha uzun süre çalışmasına izin verir [37],

Geometrik yapılarına bağlı olarak nanotüpler elektronik özelliklerini değiştirebilmektedir. TDKNT (n,m) yapıları için nanotüpler metalik, yarı metalik ve yarı iletken olarak sınıflandırılabilir. Hiçbir malzemede olmayan üstün özelliklerinden biri geniş bir iletkenlik bandına sahip olmasıdır, bu iletkenlik aralığı metallerden silisyuma kadar değişebilir. ÇDKNT'lerde ise elektronik davranış nanotüpü oluşturan grafit katmanlarının farklı kristal yapıyla çeşitlenmesinden dolayı daha karmaşıktır [18].

2.1.2.3.3 Karbon Nanotüplerin Isısal Özellikleri

Karbon nanotüpler, güçlü mekanik ve elektronik özelliklerinin haricinde ısısal özellikleriyle de araştırmalara konu olmuştur. Karbon nanotüplerin termal özelliklerine fononlar hâkimdir. TDNT'lerin ölçülen özgül ısısı, izole nanotüplerin fonon bant yapısına dayanan hesaplamaları ile yakından eşleştirir ve bu fonon yapısının 1-D miktarının ölçülmesinin doğrudan kanıtını gösterir. Bu, bir demet içindeki nanotüpler arasındaki bağlanmanın nispeten zayıf olduğunu göstermektedir.

Ölçümlere göre grafit ve elmastan daha yüksek ısısal iletkenliğe sahip tek duvarlı nanotüplerin oda sıcaklığında, tek duvarlı nanotüplerde 200 W/mK üzerinde ve çok duvarlı nanotüpler için 3000 W/mK üzerinde bir termal iletkenlik değerleri vardır [38].

2.1.2.4 Karbon nanotüplerin üretim yöntemleri

İlk kez KNT üretmek için kullanılan ark deşarjı veya lazer ablasyonu gibi yöntemler çok yüksek sıcaklıkta uygulanan tekniklerdir. Ancak günümüzde bu yöntemler düşük sıcaklıkta uygulama imkânı sağlayan kimyasal buhar biriktirme (CVD) teknikleriyle (<800 ⁰C) değiştirilmiştir. Bu yöntem sayesinde, KNT'lerin oryantasyonu, hizalaması, nanotüp uzunluğu, çapı, saflığı ve yoğunluğu tam olarak kontrol edilebilir [39].

Bu yöntemlerin çoğu destekleyici gazlar ve vakum gerektirir.Bununla birlikte, gaz fazı yöntemleri hacimseldir ve bu nedenle ekonomik olarak uygulanabilir hale getirmek için büyük miktarlarda nanotüp gerektiren bileşik malzemeler ve endüstriyel ölçekli sentez yöntemleri gibi uygulamalar için uygundurlar.Öte yandan, gaz fazı sentez yöntemlerinin dezavantajları düşük katalizör verimidir,sadece küçük bir katalizör yüzdesinin nanotüplerden dönüşümü mevcuttur dolayısıyla kısa katalizör ömrüne sahiptir [40].

Yukarıda belirtilen tekniklerde üretim sırasında knt'lerde bir takım safsızlığa sebep olan, grafit, amorf karbon, fullerenler ve sentez sırasında katalizör olarak eklenen farklı metaller (tipik olarak Fe, Co, Mo veya Ni) gibi yapılarda bulunmaktadır. Tüm bu kirlilikler CNT'lerin istenen özelliklerinin çoğuna müdahale eder ve karakterizasyon ve uygulamalarda ciddi bir engel oluşturur. Bu nedenle, CNT bilimindeki en temel zorluklardan biri,saf KNT verimi ve basit arıtma yöntemlerinin geliştirilmesidir. En yaygın saflaştırma yöntemleri, sentezlenen KNT'lerin asit muamelesine dayanır.

Plazma bazlı sentez yöntemi veya ark deşarj buharlaşma yöntemi

Ark deşarj yöntemlerinde genellikle diğer tekniklerle karşılaştırıldığında daha az yapısal kusurlu KNT'lerin büyümesine neden olan KNT sentezi için daha yüksek sıcaklıklarda (1700 °C'nin üzerinde) üretim yapılmaktadır.Başlangıçta C60 fullerenleri üretmek için kullanılan elektrik ark yöntemi, KNT'leri üretmenin en yaygın ve belki de en kolay yoludur. ÇDKNT'ler 1991 yılında ark deşarj buharlaşma tekniği ile Iijima tarafından keşfedildi. TDKNT'ler daha sonra 1993 yılında aynı yöntem ile elde edildi [41].

Bu yöntemde, C60 üretim yönteminden farklı olarak inert gaz (helyum,argon gibi) temassız olacak şekilde iki grafit elektrot arasında bir elektrik ark boşaltımı meydana gelir. Uygulanan akım iki elektrot arasında bir akışa sebep olup, yüksek sıcaklıkta buharlaşan karbon atomlarınıun bir kısmı anottan katot kısmına ilerler ve burada silindirik olarak tekrar yoğunlaşır. Karbon buharları soğuduğunda ve yoğunlaştığında ÇDKNT'ler veya TDKNT'ler oluşabilir. Genel olarak, ÇDKNT, iki grafit elektrot arasında katalizör parçacığı olmadığı zaman oluşur; TDKNT'ler ise katalizörler olarak Fe, Ni veya Co gibi metal parçacıkları (ağırlıkça %1) ilave edilerek üretilebilir[42,43]. Elde edilen ürünlerde nanotüpler ve de nanoparçacıklar bulunabilir. Sıcaklık ve plazma akımının düzenliliğine bağlı olarak üretilen KNT verimi değişim göstermektedir[44]. Bu metodun dezavantajlarından biri ürünlerin sistemden çıkarılması için KNT büyümesinin kesilmesi gerekmektedir ancak iyi bir grafit yapısı oluşturmaktadır.

Lazer aşındırma yöntemi

Lazer aşındırma yöntemi, çok yüksek sıcaklıkta çalışma, benzer optimum arka plan gazları ve katalizör gerekesinimi bakımından ark deşarj yöntemine benzerlik göstermektedir.

Lazer ablasyon yönteminde, bir grafit hedefini bir fırında buharlaştırmak için 500 Tor basınç altında yaklaşık 1200 °C sıcaklıktalazer ünitesi kullanır. Bu basıncı sabit tutmak için sistem helyum veya argon gazı ile doldurulur [42]. Buhar haline getirilen karbon yapıları helyum ve argon içeren su soğutmalı kuvars tüpün üzerinde toplanır. Elde edilen ürünler nano parçacıklar ve nano tüplerdir. Saf grafit hedefiyle katalizör parçacığı olmadığı zaman ÇDKNT oluşur. TDKNT'ler ise katalizörler olarak Co, Ni, Fe, Y gibi katalizör ilave edilerek üretilebilir. Nd-Yag ve CO₂ olmak üzere İki çeşit lazer kullanılmaktadır. Nd-Yag lazer yöntemi 1200 °C, CO₂ lazer çeşidi ise oda sıcaklığında karbon çubuğunun aşındırılma metodudur.

Fırın sıcaklığı, kullanılan katalizör ve basınç parametreleri üretimin verimine ve özellikle çap boyutlarının sabitliğine etki etmektedir.Büyük çaplı nanotüp üretiminde, yüksek lazer şiddeti önemli bir faktördür. Yüksek saflıkta karbon nanotüp elde edilmesi için en etkili yöntem olan lazerle buharlaştırma metodu yüksek maliyet ve düşük üretim kapasitesi nedeniyle çok fazla tercih edilememektedir[45-54].

Kimyasal buhar biriktirme (CVD) yöntemi

Kimyasal buhar biriktirm yenteminde gaz fazında karbon moleküllerinin ısıtılmasıyla, kaynak elde edilir. Isıtma işlemi dirençli bir bobin ve ya plazma ile gerçekleşir. Isı, molekülü atomik karbona parçalama amacı ile kullanılır. etilen, asetilen, metan, etan, ksilen ve bunlardan oluşan izobutan veya etanol benzeri hidrokarbonlar, bu yöntemde karbon kaynağı olarak kullanılır. Karbon nanotüplerin üretim sıcaklık aralığı 500-1200°C arasındadır.Sentezlenen karbon nanotüplerin oluşum hızı ve büyüme oranları , hidrokarbon ayrışmasının bir sonucu olarak reaktif türler reaktivitesine ve konsantrasyonuna bağlıdır[55-58].

Yöntem	Ark Boşalım	Lazer Aşındırma	Kimyasal Buhar
			Birikimi
Verim (%)	30 - 90	20 - 100	>70
TDKNT	-Çap uzunluğu:	-Çap uzunluğu:	-Çap uzunluğu:
	0,5-1,4nm	0,5-4 nm	1-2 nm
	-Kısa nanotüpler	-Uzun nanotüpler	-5 μm uzunluğunda nanotüpler
ÇDKNT	-Çap uzunluğu:	-Çap uzunluğu:	ÇDKNT üretimi
	1-10nm	10-240 nm	için uygun
	-Kısa nanotüpler	-Uzun nanotüpler	
Avantajları	-Ucuz,	-Oldukça yüksek	-Yüksek saflık
	-Katalizör	saflıkta üretim	-Yüksek verim, -
	kullanılmadan	-istenilen ölçülerde	istenilen ölçülerde
	ÇDKNT üretimi	çap uzunluğu	çap uzunluğu
Dezavantajları	-Yüksek sıcaklık	-ÇDKNT üretimi	-Pahalı
	-safsızlıklar	için uygun değildir	
Tek Duvarlı ve	-Her ikisi için	-TDKNT için	-Her ikisi için
Çok Duvarlı Yapılar	uygun	uygun	uygun

Çizelge 2.3 : KNT üretim yöntemleri.

2.1.3Literatür araştırması

1990'lı yılların başındaki keşfedilişlerinin ardından karbon nanotüpler ile ilgili üstün ve benzersiz özellikleri hakkında çok sayıda araştırma bulunmaktadır [59]. Hekzagonal sistemde bazal düzlemlerde C-C bağları oluşturulup(Grafen yapısı), bu bağların yuvarlatılıp silindirik şekil elde edilmesiyle oluşur.

Düşük yoğunlukları, yüksek mukavemeti, yüksek akım taşıma kapasitesi, yüksek ısı iletimi, yüksek sıcaklık kararlılığı, insan saçından 10.000 kez daha ince yapısı, mekanik olarak sağlamlığı, kovalent bağ ile bağlı yapıları, farklı yarıçaplarda çok katlı olabilen ve çok kararlı yapıları sayesinde pek çok kullanım alanları vardır.

Son yıllarda, karbon nanotüp (KNT-CNT) gaz sensörleri olarak, yüksek hassasiyet, hızlı yanıt, küçük boyut ve düşük çalışma sıcaklığı gibi mükemmel algılama yetenekleri sayesinde yoğun ilgi görmüştür[60-63].

Gaz adsorpsiyonu, elektronik cihazlar ve katalizör gibi alanlarda kullanılabilen karbon nanotüpün benzersiz özellikleri sayesinde, KNT tabanlı kimyasal gaz sensörlerini geliştirme amaçlı çok çalışma yapılmıştır[64,65].

Karbon nanotüplerin bu alanlardaki başarısının sebeplerinden biri, elektronik özelliklerinin uyarlanabilir olmasıdır. Hem büyüme sırasında hem de büyüme sonrası yöntemler kullanılarak heteroatomlar karbon nano malzemelere eklenebilir.

Nanotüp üzerinde bir karbon yerine tek bir metal atomu gelebileceği deneysel verilerle de kanıtlanmıştır. Grafen fosfor iyonları ile implante ettirilip, beklenen konfigürasyonunun tersine çevrilemez spektral kanıtları elde edilmiştir [66]. Şekil 2.9'da görüntüleri bulunmaktadır.

Ayrıca yapılan başka bir çalışmada ise geçiş metalleri KNT yüzeyine gerekli işlemler ile dağıtılarak, tek atomlu katalizörlerin sentezi ve karakterizasyonları, deneysel olarak incelenmiştir. Fe, Pd, Co ve Mn geçiş metallerinin kullanıldığı KNT numunelerinin türleri elde edilmiştir. Elde edilen yapıların geçirimli elektron mikroskobu (TEM) ve yüksek açılı açısal karanlık alan (HAADF) dedektörüne sahip taramalı-geçirimli elektron mikroskobu (STEM) görüntüleri şekil 2.10'da gösterilmiştir [67].

17







b)



Şekil 2.10 : Fe, Pd, Co, Mn metallerinin KNT üzerinde tekli atom şeklinde a) yüksek çözünürlüklü TEM b) STEM /MAADF görüntüleri.

2.2 Azot Oksit



Şekil 2.11 : Azot oksit (NO) gaussview görüntüsü.

Azot oksitlerin (NO ve NO₂) emisyonları atmosferin ve toprağın asitlenmesine ve fotokimyasal sisin oluşmasına sebep olmaktadır.Havada bulunan önemli kirleticiler arasında NO ve NO₂gazlarından oluşan NO_X gazları yer alır. Bu gazlar doğal kaynaklardan oluşabildiği gibi önemli bir miktarı ise insan faktöründen dolayı atmosfere salınmaktadır.NO_Xemisyonlarının insan yapımı ana kaynakları, ulaşım cihazlarındaki sıvı ve fosil yakıtların yanması, elektrik üretimi için enerji santralleri ve sanayi prosesleri, kimya ve azotlu gübre endüstrisidir. Atmosfere verilen NO_X gazlarının doğal kaynaklarını ise orman yangınları, toprakta oluşan mikrobiyolojik olaylar, ve yıldırımdır [68].

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği atmosferde Uzun Vadeli Sınırlar olarak NO₂ için 100 µg/m³, Kısa Vadeli Sınır olarak NO₂ için 300, µg/m³ görmektedir[69].

Yanma sıcaklıklarında NO_X' in büyük oranı azot oksit (NO) halinde olup, daha sonra atmosfer sıcaklığında zehirli olan NO₂ kolayca oksitlenebilir. NO renksiz, kokusuz bir gazdır; bitki, insan ve hayvanların solunum sistemine zararlıdır veya canlı vücudundaki oksijeni tüketebilirler[70-72]. Bu sebeple NO konsantrasyonunu en aza indirmek oldukça önemlidir.

NO sensörlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Ancak, geleneksel NO sensörlerinin yüksek çalışma sıcaklığı ve düşük algılama gibi birçok kusuru vardır. Yüksek çalışma sıcaklığı da yüksek güç tüketimine sebep olmaktadır[73,74].

Sonuç olarak, sensörlerin tasarımı için NO'ya oda sıcaklığında ölçülebilir bir cevap hayati bir önem taşımaktadır.

Günümüz teknolojisi Seçici Katalitik İndirgeme (SCR)yöntemi emisyonlarının kontrolü için kullanılır. Bu metotın dezavantajları mevcuttur. Yüksek enerji

tüketimleri, yatırım giderleri çok yüksektir. Sürekli emisyonların gideriminde kullanım zorlukları, kurulum ve işletme maliyetleri oldukça yüksektir. Atık gazlardaki NO için iki genel yaklaşım vardır. İlki NO'yu kaynağında işlemek ikincisi ise hiç üretmemektir.

NO sensörlerindeki bir diğer çözülmesi gereken problem ise, farklı yüzeylerde yapılan çalışmalardan elde edilen verilere göre, yüksek sıcaklıklarda adsorpsiyon gerçekleştiriyor olmasıdır[75-77]. Çalışma sıcaklığının yüksek oluşu güç tüketimindeki artışa ve proses zorluğunun oluşmasına sebep olur.

NO sensör çalışmalarında düşük maliyet sağlayabilmek için, çalışılan sıcaklık önemli bir ölçüdür ve bu konuda yapılan çalışmalar artmaktadır. Kullanılan nano malzemeler son yıllarda elektrikli cihazlardaki hassasiyeti yüksek miktarda arttırmış ve tek molekül algılama seviyesine getirebilmiştir.

Fakat bazı molekülleri tanımlamada çeşitli engeller meydana gelebilmektedir. Cihazlardaki elektriksel iletkenlik ve ya dalga boyu farklılıklarından kaynaklı bazı sistemler hatalar oluşabilir ya da sensör olarak cihaz kullanımını engelleyebilir[78].

Bu tarz problemlere yol açan sebeplerin önüne geçip önlem olabilmek için,sensör mekanizmalarında daha yüksek hassasiyet, iyi seçicilik, düşük güç tüketimi, daha iyi stabilite ve hızlı tepki verebilmeyi sağlayan malzemelerin kullanılması gerekir.

Belirtilmiş olduğu gibi karbon nanotüplerin gaz sensöru olarak kullanılma alanları yoğun ilgi ve talep görmüştür. Ancak NO adsorpsiyonu (NO sensör çalışması) çeşitli adsorbanlar üzerinde çalışılmış olmasına rağmen metal katkılı karbon nanotüpler üzerinde çok sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır.

Literatürde Ni, Pd, Pt metallerinin yüklendiği (6,0) karbon nanotüplerinin NO sensörü olarak kullanılabilirliğinin araştırıldığı ve karşılaştırıldığı herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

Adsorban yüzey olarak kullanacağımız karbon nanotüplere dayanan kimyasal sensörler, hızlı tepki süresi, yüksek hassasiyet ve oda sıcaklığında çeşitli gaz moleküllerini tespit etmek için kullanılmıştır[79].

Metal atomları katkılı karbon nanotüplerin NO sensörü olarak kullanılabilirliğinin araştırılarak mevcut problemlere çözüm olması ve bu alanlardaki eksikliklerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

20
Literatür araştırması yapıldığında, NO adsorpsiyonu üzerine yapılmış çeşitli teorik ve deneysel çalışmalar bulunmaktadır. Bu araştırmalar özet olarak çizelge 2.5'te sunulmuştur.

Pei(polietilenimin) ile modifiye edilen ÇDKNT (çok duvarlı karbon nanotüp) ile deneysel olarak yapılan çalışmada yapıların karakterizasyonu ve NO adsorpsiyonu ele alınmıştır [80]. β -siklodekstrin ile modifiye edilmiş çok duvarlı karbon nanotüp Li Ve Shi çalışmalarında deneysel olarak incelenmiştir. NO adsorpsiyonu ve karakterizasyon çalışmaları yapılmıştır [81]. Zhang ve arkadaşları tarafından yapılan tabanlı TDKNT (tek duvarlı karbon nanotüp) NO calısmada. floresan konsantrasyonlarını belirleme yeteneği için, tek sarmallı d (AT) 15 DNA oligonükleotid sarılmıştır. Elektronik ve yapısal özellikler incelenmiştir [82]. Hidrokarbonlar ile fonksiyonelleştirilmiş ÇDKNT Jimenez ve arkadaşları tarafından deneysel olarak incelenmiştir. NO'nun hidrokarbonlar ile işlevselleştirilmiş metal katkılı çok katlı karbon nanotüp katalizörler üzerindeki seçici katalitik indirgenmesi, kinetik ve adsorpsiyon ölçümleri araştırılmıştır. Reaksiyon aktivitesi ve sıcaklık etkileri karşılaştırılmıştır [83]. Li ve arkadaşları tarafından teorik olarak Vienna ab initio simulation package (VASP) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Farklı boyut ve yapıdaki karbon silikon nanotüpler üzerinde CO (karbon monoksit) ve NO sensör çalışmaları yapılmıştır [84]. Li ve arkadaşları tarafından teorik olarak Vienna ab initio simulation package (VASP) kullanılarak yapılan diğer çalışmada Metal (Pt,Pd) katkılı TDKNT araştırması yapılmıştır. Farklı konfigürasyonlarda Pt ve Pd katkılı karbon nanotüpler üzerinde CO (karbon monoksit) ve NO adsorpsiyonları, elektronik ve yapısal özellikleri, enerji hesapları ve bağ uzunlukları incelenmiştir [85]. Vermisoglou ve arkadaşları tarafından yapılan çalışma deneysel olarak yapılmıştır. Rh katkılı polietilen glikol ile fonksiyonelleştirilmiş TDKNT kullanılmıştır. Bu çalışmalar, reaksiyon kinetikleri ve katalizörün ömrünü, verimli NO uzaklaştırması için optimum reaksiyon koşullarını tanımlanmıştır. Karakterizasyon çalışmaları yapılarak sıcaklık etkileri karşılaştırılmıştır [86]. Sen ve arkadaşları tarafından yapılan deneysel çalışmada nitrik oksit (NO) sensörü ve NO duyarlılığının araştırılması yapılmıştır, TDKNT incelenmiştir [87]. Yapısal ve elektronik özellikler karşılaştırılmıştır. SO2 katkılı Fe-Cu-OX / CNTs- TiO2 yapısı deneysel olarak Ma ve arkadaşları tarafından çalışılmıştır. Adsorpsiyon, karakterizasyon çalışmaları yapılmış ve NO'nun NO₂'ye oksidasyonu incelenmiştir. Sıcaklık etkisi ve fiziksel

özellikleri karşılaştırılmıştır [88]. Liang ve arkadaşları tarafından adsorpsiyon deneysel olarak çalışılmıştır. NO sensörlerdeki hassasiyet, tespit limiti ve zaman optimizasyonunu sağlanmıştır [89]. Germanyum (Ge) katkılı tek duvarlı bor nitrür nanotüpler Wang ve arkdaşları tarafından incelenmiştir. Teorik olarak yapılan araştırmada NO adsorpsiyonu, yapısal ve elektroniksel özellikleri elde edilip kararlı yapı karşılaştırılması yapılmıştır [90]. Vasylenko ve arkadaşları tarafından yoğunluk fonksiyonel teorisi(dft) ile teorik olarak çalışma yapılmıştır. Bu yapılan çalışmada karbon nanotüplerin boşluklu yapılarının adsorpsiyon üzerine etkileri incelenmiştir. Elektronik özellikler, enerji hesapları, bağ açıları ve uzunlukları elde edilmiştir [91]. Ir4 katkılı tek duvarlı karbon nanotüp çalışması Du ve diğerleri tarafından yapılmıştır. NO adsorpsiyonu yoğunluk fonksiyonel teorisi (dft) ile teorik olarak çalışılmıştır. Farklı konfigürasyon karşılaştırılması yapılmıştır. Yapının elektronik özellikleri, enerji hesapları, bağ açıları ve uzunlukları elde edilmiştir [92]. Karbon nanotüpler üzerine modifiye edilmiş nanolevha MnO2 üzerinde NO adsorpsiyonu Zhang ve arkadaşları tarafından araştırılmıştır. Yapılan çalışma deneyseldir. Karakterizasyon verileri elde edilmiş ve NO 'nun O2 ve NO2'ye dönüşümü incelenmiştir [93]. Liu ve arkadaşları tarafından yapılan çalışma teorik olarak çalışılmıştır. Kalsiyum ve potasyum katkılı TDKNT ve katkısız TDKNT çalışmaları NO adsorpsiyonu için incelenmiştir. Yapıların optimizasyonu yapılıp, elektronik özellikleri, enerji hesapları, bağ açıları ve uzunlukları elde edilmiştir [94].

Adsorban	Deneysel / Teorik	İncelenen Özellikler	Kaynakça
peı(polietilenimin) ile modifiye edilen ÇDKNT (çok duvarlı karbon nanotüp)	Deneysel	-karakterizasyon -adsorpsiyon	[80]
β-siklodekstrin ile modifiye edilmiş ÇDKNT	Deneysel	-karakterizasyon -adsorpsiyon	[81]
d (at) 15 DNA oligonükleotid ile sarılmış tdknt	Deneysel	-adsorpsiyon -elektronik özellikler - yapısal özellikler	[82]
Hidrokarbonlar ile fonksiyonelleştirilmiş ÇDKNT	Deneysel	-adsorpsiyon -reaksiyon aktivitesi -sıcaklık etkileri -kinetik veriler	[83]
Silikon nanotüp	Teorik (DFT)	 adsorpsiyon Optimize Geometrik Parametreler ve elektronik özellikler Çeşitli Konfigürasyonlar için 	[84]
Metal (Pt,Pd) katkılı TDKNT	Teorik	-adsorpsiyon -elektronik özellikler -enerji hesapları, bağ uzunlukları - yapısal özellikler	[85]
Rh katkılı Polietilen glikol ile fonksiyonelleştirilmiş TDKNT	Deneysel	-adsorpsiyon -karakterizasyon -sıcaklık etkisi	[86]
d (at) 15 DNA oligonükleotid ile sarılmış tdknt	Deneysel	-adsorpsiyon -yapısal özellikler -elektronik özellikler	[87]
SO2 katkılı Fe–Cu–OX/CNTs– TiO2	Deneysel	-adsorpsiyon -karakterizasyon -sıcaklık etkileri -fiziksel özellikler	[88]
nanotüp ve grafen	Deneysel	-adsorpsiyon -sensör	[89]

Çizelge 2.4 : NO adsorpsiyonu üzerine yapılmış teorik ve deneysel çalışmalar.

germanyum (Ge) katkılı tek duvarlı bor nitrür nanotüpler	Teorik (DFT)	- adsorpsiyon -yapısal özellikler -elektronik özellikler -kararlı yapı karşılaştırılması	[90]
boşluklu TDKNT	Teorik (DFT)	-adsorpsiyon -elektronik özellikler -enerji hesapları, bağ açıları ve uzunlukları	[91]
Ir4 katkılı TDKNT (tek duvarlı karbon nanotüp)	Teorik (DFT)	-adsorpsiyon -elektronik özellikler -enerji hesapları, bağ açıları ve uzunlukları	[92]
karbon nanotüpler (knt) üzerine modifiye edilmiş nanolevha MnO ₂	Deneys el	-adsorpsiyon -karakterizasyon -NO 'nun O ₂ ve NO ₂ 'ye dönüşümü	[93]
kalsiyum ve potasyum katkılı TDKNT	Teorik (DFT)	-adsorpsiyon -elektronik özellikler -enerji hesapları, bağ açıları ve uzunlukları	[94]

Çizelge 2.4 (devam) : NO adsorpsiyonu üzerine yapılmış teorik ve deneysel çalışmalar.

2.3 Gaz Sensör Mekanizmaları

International Union of Pure and Applied Chemistry – IUPAC tarafından tarafından verilen gaz sensörünün tanımına göre, belirli bir numune bileşeninin konsantrasyonundan değişen kimyasal bilgileri bir sinyale dönüştüren cihazdır.

Tipik olarak, kimyasal sensör cihazları bir reseptör ve bir transdüser olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Reseptör, kimyasal bilgiyi bir enerji formuna dönüştürürken, transdüser tarafından ölçülebilir. Transdüser bu enerjiyi kullanışlı, elektriksel bir analitik sinyale dönüştürür [95].

Kimyasal sensörler, transduserin çalışma sistemine göre çeşitli sınıflara ayrılabilir. Bu sınıflandırmaya göre; termal,katalitik, elektrokimyasal, optik, kızılötesi, yarıiletkenve yüzey akustik dalga çeşitleri olarak ayrılabilirler[96].Tez kapsamında yapılan Ni, Pd, Pt katkılı karbon nanotüplerin üzerinde NO adsorpsiyon çalışması elektrokimyasal metod olarak sınıflandırılabilir. Gaz sensör tiplerinin avantajları ve dezavantajlarıyla birlikte karşılaştırılması şeklinde bir özet Çizelge 2.5'te gösterilmiştir.

Sensör Tipi	Avantajları	Dezavantajları		
Termal	-Oksijensiz ortamda kullanımı kolaydır.	-Isıtma teli nedeniyle reaksiyon oluşabilir.		
	-Ölçüm aralığı çok geniştir.			
Katalitik	-Basit, gazların yanıcılığını ölçer.	-Çalışması için hava veya oksijen gerekir.		
	-Düşük maliyetli teknolojidir.	-Kurşun, klor ve silikon ile zehirlenebilir.		
Elektrokimyasal	-Toksik gazları nispeten düşük konsantrasyonlarda ölçer.	-Arıza sebepleri, gelişmiş izleme tekniği kullanılmadıkça		
	-Çok çeşitli gazlar algılanabilir.	ortaya çıkarılamaz.		
Optik	-Oksijensiz ortamda kullanımı kolaydır.	-Ortamdaki 151k girisiminden		
	-Elektromanyetik parazitlerden etkilenmez.	etkilenir.		
	-İzleme alanı çok geniştir.			
Kızılötesi	-Sadece fiziksel teknik kullanır.	-Her gazın IR emilimi yoktur.		
	-Görülmeyen hata modları yoktur.	- Daha fazla kullanıcı uzmanlığı gerekir.		
	-İnert atmosferlerde kullanılabilir.			
Yarı İletkenler	-Mekanik olarak sağlam, sürekli yüksek nem koşulunda iyi çalışır.	-Kirleticilere ve çevre koşullarından kaynaklanan değişikliklere karşı hassastır.		
		-Doğrusal olmayan yanıt karmaşıklığa sebep olur.		
Yüzey Akustik Dalga	-Aküsüz ve kablosuz uygulamalar için kullanılabilir.	-Küçük boyutlu olması nedeniyle imalat işlemi		
	-Sert ve dönen parçalara yerleştirilebilir.	vardır.		

Çizelge 2.5 : Gaz sensor tiplerinin avantajları ve dezavantajları.

2.3.1Yüzeye adsorbe edilmiş oksijen iyonları mekanizması

Geleneksel metal oksit bazlı gaz sensörlerinde (ZnO, SnO2 vb.), algılama mekanizması yüzeyleri negatif yüklenmiş oksijen iyonlarıyla ilgilidir. Normal çalışma sıcaklığı aralığında (200 °C - 500 °C), O ve O₂ gibi oksijen negatif iyonlar metal oksitlerin yüzeyine adsorbe edilir ve negatif olarak yüklenir.

Metal oksitleri ile reaksiyona giren çeşitli gazlar, oksijen negatif iyonları ile etkileşime girecek ve metal oksitlerin iletkenliğini değiştirecektir. İndirgeyici bir gaza maruz kaldıktan sonra, metal oksitlerin iletkenliğini artırarak, oksidasyon nedeniyle negatif bir yüke sahip olurlar. Ancak eğer adsorbe edilen gaz elektron kabul edilen bir gaz mevcutsa, metal oksitlerin iletkenliği azalır [97].

2.3.2 Yük transfer mekanizması

Geçtiğimiz birkaç on yıl boyunca, yüksek hassasiyet ve nispeten düşük maliyetli olması nedeniyle, metal oksit yarı iletkenleri, geleneksel kimyasal algılama malzemeleri olarak uygulanmıştır. Ancak yine de bazı kritik dezavantajları vardır. İlk olarak, metal oksit yarı iletkenleri oda sıcaklığında zayıf hassasiyet ve seçicilik sergiler. Bu engel, karbon nanotüpler, grafen gibi alternatif malzemelerin geliştirilmesine yol açmıştır [98]. Geleneksel metal oksitlerden farklı olarak yük transfer mekanizmasında, grafen ve ilgili katmanlı yapıların gaz algılaması temel olarak yük transfer işlemlerine dayanır, Yük transferinin olduğu sensörler yük alan ya da veren taraf olabilirler. Genel olarak, KNT'lerin gaz moleküllerine maruz kalması üzerine elektronik özellik değişiklikleri, moleküller ve nanotüpler arasındaki yük transferine bağlıdır.

Tez kapsamında yapılan Ni, Pd, Pt katkılı karbon nanotüplerin üzerinde NO adsorpsiyon çalışması yük transfer metodu ile yapılmıştır.

Bir karbon nanotüp alan etkili transistörü (carbon nanotube field-effect transistor -CNTFET), kanal malzemesi olarak geleneksel yapıdaki dökme silikon yerine tek bir karbon nanotüp veya bir dizi karbon nanotüp kullanan transistörünü belirtir. İlk 1998'de gösterildi,CNTFET'lerde o zamandan beri önemli gelişmeler oldu[99,100]. Sp² konfigürasyonundaki güçlü kovalent karbon-karbon bağı nedeniyle, karbon nanotüpler kimyasal olarak inert olup,büyük miktarda elektrik akımı taşıyabilirler. Teoride, karbon nanotüpler aynı zamanda neredeyse elmas veya safir gibi ısı da iletebilirler ve minyatür boyutlarından dolayı CNTFET silikon bazlı bir cihazdan çok daha az güç kullanarak güvenilir bir şekilde geçiş yapmalıdır [101]. Bu yöntemle aynı çip üzerinde farklı metal nano malzemeler ile dekore edilmiş CNTFET cihazı görüntüsü şekil 2.12'de gösterilmiştir [102].



Şekil 2.12 : Farklı metal nano malzemeler ile dekore edilmiş CNTFET cihazı görüntüsü.

2.4 Hesaplamalı Kimya

Hesaplamalı kimya, moleküllerin ve katıların yapı ve özelliklerini hesaplamak ve bu programları gerçek kimyasal problemlere uygulamak için teorik kimyanın sonuçlarını kullanan bilgisayar programları üzerinde hesaplamaların yapıldığı ve simüle edildiği bir kimya dalıdır. Kimyagerler ve fizikçilerin birlikte yaptıkları teorik çalışmalarda, atomik ve moleküler özelliklerini ve kimyasal reaksiyonlarda reaksiyon yollarını tahmin etmek için algoritmalar ve bilgisayar programları geliştirirler. Hesaplamalı kimya çok önemli problem çözümlerinde kullanılan etkin ve en önemli uygulamalarından biridir.

- Deneysel sonuçların desteklenmesini ve molekülün tüm spektroskopik özelliklerinin incelenmesini sağlayan bu yöntem sayesinde daha hızlı ve kolay veri elde edilebilir.
- Fizikokimyasal problemlere yeni bakış açıları getirilmesini sağlar.
- Moleküler özelliklerin eldesi deneysel olarak, teorik hesaplamalara kıyasla daha zordur. Sentezlenememiş maddelerin incelenebilmesini ve laboratuvarda

sentezlenmesine yol gösterir, zamandan ve maddi kaynaklardan tasarruf sağlar.

• Mekanizmasını deneysel yollarla takip edemediğiniz reaksiyonların mekanizmalarının önerilmesini sağlar.

Bu hesaplamalar ile elde ettiğimiz veriler şekil 2.13'te özetlenmiştir.Günümüz teknolojisinde, moleküler biyoloji, ilaç tasarımı ve etkileşimi, polimer biyokimya, ve üstün nitelikli yeni maddelerin sentezi, araştırma ve endüstriyel açıdan yoğun biçimde kullanılmaktadır. Farklı yaklaşımlar uygulanarak Schrödinger denkleminin çözülmesi sonucu çeşitli programlar ve farklı metodlar elde edilmiştirz. Hesaplamalı kimyada bu alandaki çözüm yöntemleri 3 ana başlık altında toplanır. (Şekil 2.14)

- Moleküler mekanik
- Elektronik yapı kuramı
- Moleküler Dinamik

Enerji ΔΕ, ΔΗ, ΔG	HOMO-LUMO	IR Spektrumları
Geometrik Yapı Geometrik Yapı ESP	Atomik Yükler	Yapısal Parametreler (Bağ Uzunlukları ve Bağ Açıları)

Şekil 2.13 : Hesapsal kimya ile elde edilebilecek veriler.



Şekil 2.14 : Hesaplamalı kimya çözüm yöntemleri.

2.4.1 Moleküler mekanik yöntemler

Moleküler mekanik, moleküllerin yapılarını ve özelliklerini klasik fizik kanunlarını uygulayarak inceleyen yöntemdir. Molekülün minimum toplam potansiyel enerjisini bulunup molekül yapısı incelenir. Bu yöntemde elektronlar hesaplamalara katılmaz. Bu sebeple10⁴ atom sayısına ulaşan çok büyük yapılar için hesaplamalar bu yöntemle yapılabilir.Bu yöntemlerle kadar atom içeren oldukça büyük bileşiklerin hesaplamaları yapılabilir.Moleküler Mekanik, bazı varsayımlara dayanmaktadır;

- Elektronları bir çekirdeğin etrafına ve çekirdeğin kendisine mükemmel bir küre gibi davranır.
- Moleküller arasındaki bağlar yaylar olarak değerlendirilir.
- Potansiyel fonksiyonlar deneysel parametrelere dayanır (kuvvet sabitleri ve denge değerleri gibi.)

Moleküler mekanik, kuantum mekaniksel bir yöntem değildir. Kimyasal tepkimeleri incelemek ve bağların kırıldığını görebilmek için moleküler mekanik yöntemini uygulamak uygun değildir. Bu durumlar için daha çok kuantum mekanik ve moleküler mekanik yöntemlerini içeren farklı yöntemler geliştirilmiştir. Alchemy, Quanta, HyperChem, Sybyl ve Gaussian paket programlarındadeğişik moleküler mekanik metodlar vardır. Mekanik yöntem çeşitlerinden olan AMBER ve CHARMM polipeptidler, proteinler ve nükleik asitleri incelemek için kullanılabilir.

MM2 yöntemi ile orta boyuttaki organik moleküller, MMFF94 yöntemi ile daha küçük organik moleküller ve nükleik asitler, MM3 yöntemi ile ise polipeptidler, organik bileşikler incelenebilmektedir.

2.4.2 Moleküler dinamik yöntemler

Dinamik bir sistemde yer alan atom ve moleküllerin hareketlerine göre sistemi modelleyen bir yöntemidir. Bu yöntem, Newton'un hareket denklemini çözmeyi içerir. Newton un hareket denklemlerinin hesaplanması ile yapıların yörüngeleri hakkında bilgi elde edilir; F = ma. Moleküler mekanik kuvvet alanları ile tanımlanan potansiyel enerji ve kuvvetler, sistem içindeki taneciklerin etkileşimlerinin elde edilmesini sağlar.

2.4.3 Elektronik yapı yöntemleri

Moleküller çekirdek ve elektronlardan oluşur, bu yüzden kuantum mekaniği yöntemleri uygulanır. Prensip olarak Schrödinger denklemini, zamana bağlı ya da eldeki soruna uygun zamandan bağımsız bir biçimde çözmek mümkündür, ancak sistemler dışında mümkün pratikte bu çok küçük değildir. Mevcut durumda,Schrödinger denklemi hidrojen atomu doğru bir şekilde hesaplanabilmiştir.Çok elektronlu yapılar için tam olarak çözümleyebilmek şu an için imkansızdır. Bazı yaklaşımların yapılması ile çözümleri bulunabilir.Kuantum mekanik yasalar elektronik yapı yöntemlerinde kullanılan hesaplamaların temelini oluşturur. Schröndinger denkleminin çözümü sonucu edinilen veriler kuantum mekaniği hesaplamalarına göre bir molekülün enerjisi ve sahip olduğu diğer özellikleri hakkında bilgi verir. Fakat oldukça karışık bir denklem olan Schröndinger denkleminin tam çözümü küçük bir molekül için bile oldukça zordur. Schröndinger eşitliğinin yöntemleri çözümü için farklı matematiksel yaklaşım kullanılır.Schrödinger denklemi;

$$\hat{H}\Psi = E\Psi \tag{2.2}$$

Ĥ Toplam enerji operatörüdür. Hamilton operatörü moleküldeki parçacıkların enerjisini ve bütün parçacıkların birbirleri arasındaki elektrostatik etkileşimlerini simgeler.E Enerji ve Ψise dalga fonksiyonunu temsil eder. Bu yaklaşım yöntemleri ile elektronik yapı yöntemlerinin uygulamaları çeşitlenir. Bu sebeple, elektronik yapı yöntemleri üç ana başlıkta toplanır:

- Yarı-deneysel yöntemler
- Ab-initio yöntemler
- Yoğunluk fonksiyoneli kuramı

2.4.3.1 Yarı-deneysel yöntemler

Yarı-ampirik kuantum kimyası yöntemleri Hartree-Fock formalizmine dayanır, ancak birçok yaklaşımda bulunur ve ampirik verilerden bazı parametreler elde eder. 100-10000 atomlu sistemlere uygulanabilirler. Ampirik parametrelerin kullanımı, bazı korelasyon etkilerinin yöntemlere dahil edilmesine izin verir. Yapılan bu yaklaşımlar sayesinde hesaplama süresi ab initio yöntemine kıyasla daha kısadır.

2.4.3.2 Ab-İnitio yöntemler

Hesaplamalı kimyada kullanılan programlar, Hamilton operatörü ile ilişkili Schrödinger denklemini çözen birçok farklı kuantum kimyasal metoda dayanmaktadır. AB initio yöntemi tamamen kuantum teorisinin prensiplerine dayalı olarak türetilirler. Denklemlerinde herhangi bir ampirik veya yarı ampirik parametre içermeyen yöntemlerdir. Bu, çözümün kesin olduğu anlamına gelmez. Hepsi yaklaşık kuantum mekanik hesaplamalarıdır. Bu, belirli bir yaklaşımın dikkatlice tanımlandığı ve daha sonra mümkün olduğu kadar çözüldüğü anlamına gelir. Çeşitli ab-initio yöntemi vardır. Bunlar Hartree-Fock (HF) yöntemi, elektron korelasyon yöntemlerinden Møller-Plesset Perturbation Theory (MP) yöntemi, konfigürasyon etkileşimi(CI) ve eşleşmiş yığın teorisi (CC) gibi yöntemlerdir.

2.4.3.3 Yoğunluk fonksiyoneli teorisi (dft) yöntemleri

Elektronik yapı teorisindeki geleneksel yöntemler, özellikle Hartree-Fock teorisi karmaşık çok elektronlu dalga fonksiyonuna dayanır. Yoğunluk fonksiyonu teorisinin temel amacı, çok elektronlu dalga fonksiyonunu, elektronik yoğunluk ile değiştirmektir. DFT yönteminde toplam enerji, dalga fonksiyonundan ziyade toplam elektron yoğunluğu cinsinden ifade edilir.Fonksiyonel, fonksiyonunun fonksiyonu demektir. Elektron yoğunluğu dalga fonksiyonunun karesinin tüm elektronlar üzerinden integrali ile hesaplanır. Atomik bir sistemin elektronik temel hal enerjisinin sadece elektron yoğunluğundan belirlenebileceği teorisi Hohenberg ve

Kohn tarafından 1964'te geliştirildi. Günümüzde DFTmetodları elektronik enerjiyi birkaç terimin toplamı olarak tanımlar.

$$E = E^{T} + E^{V} + E^{J} + E^{XC}$$
(2.3)

 E^{T} = Elektronların hareketinden ortaya çıkan kinetik enerjiye ait terim

 E^{V} = Çekirdek elektron çekimlerine ve çekirdek çiftlerinin itmesine ait potansiyel enerjiyi tanımlayan terimler

 E^{J} = elektron elektron itmesine ait terim

 E^{XC} = Geriye kalan diğer elektron elektron etkileşimlerini kapsar. Kısaca değişimkorelasyon terimi olarak tanımlanır.

Değiş-tokuş korelasyon enerjisini veren fonksiyonun ne olduğu bilinmemektedir. Bu nedenle, yoğunluk fonksiyoneli teorisinin temel amacı bu enerjiyi en iyi şekilde tanımlayabilen bir fonksiyonelin bulunmasıdır. Bu da DFT yöntemlerinin neden bu kadar çeşitli olduğunu açıklamaktadır. Moleküle uygun bir yöntem seçilip uygulanmalıdır.

Moleküler mekanik yöntem, yarı-deneysel yöntem, DFT yöntemi ve sonrasında Abinitio yöntemi olan MP2 yöntemine doğru gidildikçe hesaplamalardaki hassasiyet artar ancak bununla beraber hesaplama zorluğu da artıp, daha fazla bilgisayar gücü gerektirir.



Şekil 2.15 : a) propilen b)fulleren yapılarının hesaplamaları için işlemci zamanları.

3.YÜZEY MODELİ VE YÖNTEM

Tez kapsamında yapılan bu çalışmada metallerin (M = Ni, Pd ya da Pt) yüklendiği (6,0) karbon nanotüplerinoda sıcaklığında NO sensörü olarak kullanılabilirliği için karşılaştırılacak olan özellikleri kuantum kimyasal hesap yöntemlerinden biri olan DFT (Density Functional Theory - Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi) yardımıyla tespit edildi[103]. Yapılan hesaplamalarda tüm kuantum kimyasal hesaplar üniversitemizin lisansına sahip olduğu Gaussian 09 kuantum kimyasal yazılımının Linux sürümü kullanılarak yapılmıştır [104]. Gaussian yazılımının yardımcı yazılımı olan Gausview programı karbon nanotüp yapılarını ve "input" dosyalarını oluşturmak için kullanıldı.Tüm hesaplamalarda uygulanacak olan en uygun fonksiyonel/temel set kombinasyonu seçilmiştir.Kuantum kimyasal hesaplarda WB97XD metodu kullanılmıştır. WB97XD metodu Grimme'nin D2 dağılım modelinin bir sürümünü kullanan çok güncel bir dağılım dâhil hibrit DFT metodudur. Elementler için kullanılacak olan temel setler (basis setler) ise literatürde kuantum kimyasal hesaplarda cok sık bir sekilde kullanılan LanL2dz ve 6-31G(d,p)'dir. Burada LanL2dz temel seti metal atomları(Ni, Pd, Pt) için, 6-31G(d,p) temel seti ise diğer atomlar(C, H, N, O) için kullanıldı [105,106].

Kuantum kimyasal hesaplar yapılacak olan karbon nanotüp yapıları tek duvarlı tüp şeklinde tasarlandı. NO adsorpsiyon ve algılama çalışması için yarımetalik özellik gösteren 72 karbon atomundan oluşan zikzak model (6,0) TDKNT kullanıldı. Yapı(cluster) üzerindeki nötr yük için nanotüpün serbest karbon atomlarının bağlarının son kısımlarına hidrojen (H) atomları (toplam 12 atom) eklendi. Ek olarak, metal atomları(Ni, Pd, Pt) sırası ile yapı üzerindeki bir karbon atomunun yerini aldı. Yükleme işlemi karbon nanotüpler yüzeyinde rahatlıkla oluşan karbon boşluklarına yapıldı. Nanotüp üzerinde bir karbon yerine tek bir metal atomu gelebileceği deneysel verilerle de kanıtlanmıştır. Grafen fosfor iyonları ile implante ettirilip, beklenen konfigürasyonunun tersine çevrilemez spektral kanıtları elde edilmiştir [107].

Şekil 3.1'de yaklaşık 13.5Å uzunluğunda tek duvarlı (6,0) karbon nanotüp yapısı görülmektedir.



Şekil 3.1 :(6,0) karbon nanotüp yapısı.

Karbon nanotüp yapılarının merkezlerinde yer alan petek karbon halkası içerisinde bulunan tek C atomunun yerine metal yükleme işlemleri yapıldı. Karbon nanotüp yapısının uç etkilerinin metal yükleme yeri üzerine etkisi (edge effects) oluşmasını engellemek için bu yönteme başvuruldu. Bu şekilde olan yaklaşım (herhangi bir yükleme işleminin seçilen yapı üzerinde merkezde olacak şekilde olması) literatürde çok fazla kullanılan bir yaklaşımdır. Seçilmiş olan Ni, Pd, Pt metalleri katkılı KNT yapıları şekil 3.2'de gösterilmiştir.



Şekil 3.2 : a) Ni, b) Pd, c) Pt metal katkılı (6,0) KNT yapıları.

İlk olarak, yapı ve NO molekülleri için SM (Spin Multiplicity) Spin Çokluğu değerlerini bulabilmek amacıyla, SPE (single point energy) tek nokta enerji hesaplamaları hesaplandı. Farklı SM değerleri verilerek sistemler için SPE değerleri elde edildi. Bu sonuçlara göre, en düşük enerjiyi veren SM değeri, ilgili sistem için

nihai SM değeri olarak kabul edildi. Daha sonra metal atomlarının karbon nanotüp yapısına yerleştirilmesi ile elde edilen geometriler EG (Equilibrium Geometry,) Denge Geometri hesabı ile optimize edilerek en uygun geometri elde edildi. Bu geometri elde edildikten sonra ise NO molekülü denge geometri hesabı yapılmış olan optimize metal-karbon nanotüp geometrisi üzerine yerleştirilerek tekrar Denge Geometri hesabı ile en uygun geometriye getirildi. Böylece NO molekülünün metal-karbon nanotüp yüzeyi üzerinde optimize edilmesi sağlanmış oldu. NO molekülü karbon nanotüp üzerindeki metal atomunun üzerine hem N hem de O tarafından yerleştirilerek yapılan hesap tekrarlandı.

Adsorpsiyon göreli enerji değerlerini hesaplamak için aşağıdaki denklem kullanılmıştır

$$\Delta(E/H/G) = (E/H/G)_{\text{Sistem}} - [(E/H/G)_{\text{Adsorplanacak}} + (E/H/G)_{\text{Yapl}}]$$
(3.1)

E_{System} NO molekülünün adsorplanığı karbon nanotüp yapısının termal enerji değeridir. E_{Adsorplanacak}değeri bu çalışma için NO molekülünün adsorpsiyon öncesi termal enerjisi ve E_{yapı} değeri ise NO molekülü eklenmeden önceki karbon nanotüp yapısının ilk termal enerjisidir. Ayrıca karbon nanotüp üzerinde azot oksit adsorpsiyonu için entalpi (Δ H), ve Gibbs serbest enerji (Δ G) değerleri de aynı denklem ile elde edilmiştir.Bu yapılar için frekans hesapları, frekans anahtar kelimesi (freq) kullanılarak elde edildi.

Bu geometrilerin enerji değerleri hesaplanırken bu değerleri etkileyen ve deneysel verilerle daha uyumlu olmasını sağlayan Sıfır Noktası Enerji Düzeltmesi (Zero Point Energy Correction, ZPE) değerleri (frekans hesabı ile elde edilmektedir) kullanıldı.Ayrıca, titreşim frekansı, termal enerji, entalpi ve serbest enerji değerleri gaussian programınde 298,15 K ve 1 atmosfer basınçta hesaplandı.

NO adsorpsiyonu için bu enerji değerleri şu şekilde hesaplandı:

$$E = E_{elektronik} + ZPE + E_{titreşim} + E_{dönme} + E_{öteleme}$$
(3.2)

$$H = E + RT \tag{3.3}$$

$$G = H - TS \tag{3.4}$$

E, elektronik ve sıfır nokta enerjilerinin (ZPE) ve termal (öteleme, titreşim, dönme) enerjilerin toplamıdır. H elektronik ve termal entalpilerin toplamıdır, Gelektronik ve termal serbest enerjinin toplamıdır, S entropidir ve Ttitreşim frekansı hesaplamaları için kullanılan sıcaklıktır.Ölçeklendirme faktörü, tüm titreşim frekans değerleri için 0,9613 olarak kullanılmıştır [108].

HOMO(Highest Occupied Molecular Orbital) en yüksek dolu moleküler orbital ve LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital) en düşük boş moleküler orbital değerleri elde edildi.

HOMO enerjisi elektron verme isteği, LUMO enerjisi ise yapının elektron alma isteğini gösteren değerlerdir.HOMO ve LUMO değerleriyle ilişkili olarak elektron ilgisi (A) ve iyonizasyon potansiyeli (I) hesaplandı. Daha sonrasında elde edilen verilerle Kimyasal sertlik (η), Elektronegatiflik (X), Kimyasal sertlik ($\dot{\eta}$) değerleri bulundu.

Moleküller için kimyasal sertlik değerindeki artış, molekül içi yük taşınımının düşük olduğunu ya da olmadığını gösterir. Molekülden bir elektron koparmak için ihtiyacımız olan en düşük seviyedeki enerji bize İyonizasyon potansiyelini(I) gösterir. Molekül gaz fazında olduğu durumlarda moleküle bir elektron eklendiği durumlarda enerjideki yükseliş değeri Elektron ilgisi (A) olarak adlandırılır.

Sertlik bir molekülün reaksiyona girme durumu hakkında yorum yapabilmeyi sağlar. Polarize olma kabiliyetinin daha zor olduğu ve düşükbir kimyasal tepki moleküle, sert molekül denir[109-111].HOMO ve LUMO enerji değerleri arasındaki fark ise molekülün kimyasal kararlılığı olarak tanımlanabilir [112].

Bu değerlere aşağıdaki denklemler kullanılarak ulaşıldı.

Kimyasal sertlik (
$$\eta$$
) = $\frac{I-A}{2}$ (3.5)

Kimyasal potansiyel (
$$\mu$$
) = $-\frac{I+A}{2}$ (3.6)

Elektronegatiflik (
$$\lambda$$
) = $-\mu$ (3.7)

$$I \cong -\epsilon_{HOMO} \ ve \ A \cong -\epsilon_{LUMO} \tag{3.8}$$

Kuantum kimyasal hesaplar sırasında karbon atomlarının uçlarına eklenen hidrojen atomları hariç tüm atomlar serbest tutuldu. Karbon atomlarının uçlarına eklenen hidrojen atomları bir sonraki karbon atomunun doğrultusunu belirtmek amacıyla sabit tutuldu. Ayrıca durum yoğunluğu (density of states -DOS) grafikleri gaussSum 3.0 programı ile elde edildi [113]. Mulliken atomik atom yükleri Mulliken popülasyon analizi ile elde edildi ve doğal bağ orbitali (Natural Bond Orbital-NBO) analizleri ile NBO atomik yükleri bulundu [114].



4.BULGULAR VE TARTIŞMA

İlk olarak, spin değerlerini bulmak için karbon nanotüp ve NO molekülün SPE hesapları yapıldı. Bulunan spin değerleri ile yapılar ve NO molekülü optimize edilerek minimum enerjili geometrileri elde edildi. Optimize edilen NO molekülünün azot ve oksijen atomları arası bağ uzunluğu 1,5870 Å olarak elde edildi. NO molekülünün titreşim frekansı 1991,068 cm⁻¹ olarak IR spektrumundan okundu. Grafik gösterimi şekil4.1'de gösterilmiştir.



Şekil 4.1 : NO molekülü IR spektrumu.

Metal atomları karbon nanotüp (6,0) yapısındaki 32 numaralı C atomunun yerine yüklenmiştir. Metal yüklenmeden önceki karbon nanotüp yapısında yerine metal yüklenceek C32atomu ve bağ oluşturduğu 3 karbon atomu arasındaki C-C bağ uzunlukları sırası ile 1,43417 Å, 1,43417 Å, 1,41428 Å olarak hesaplanmıştır. C-C bağ uzunlukları önceki çalışmalarda da benzer uzunluklarda hesaplanmıştır. C32 atomu ve diğer üç karbon arasındaki bağ açıları sırası ile 113,8°, 119,9°, 119,9° olarak elde edilmiştir. Optimize edilen KNT(6,0) yapısına daha sonrasında metal yükleme yapılarak C atomu cıkartılıp, yerine sırası ile Ni, Pd ve Pt atomları yerleştirildi. Yükleme işlemi sonrasında metal katkılıher yapı için tekrar spin değerlerini hesaplayabilmek için SPE hesapları yapıldı. Bulunan değerler ile optimizasyon yapılarak en düşük enerjili geometrileri elde edildi. Elde edilen yapılar şekil 3.2'de gösterilmiştir.C atomu yerine yerleştirilen metallerin etrafındaki en yakın üç C atomuyla olan uzaklıkları tablo 4.1'de gösterilmiştir. 1,792 Å – 2,014 Å arasında değişen bu uzunluk, metal yüklenmesi yapılmadan önce KNT üzerindeki C-C bağ uzunluğuna göre daha yüksektir. Literatürde yapılan diğer çalışmalarda karbon

nanotüp üzerindeki C-Ni, C-Pd, C-Pt uzunlukları ortalama olarak sırası ile 1,852Å, 2,130 Å, 2,063 Å olarak elde edildi[85,115]. Değerler birbirine genel olarak yakındır. Metal atomları ile üç C atomunun açıları adsorpsiyon öncesi ve sonrası olarak çizelge 4.2'de gösterildi. Açı değerleri metal yüklemeden sonra küçülerek atomların birbirine yaklaştığı gözlendi.

Çizelge 4.1 :Metal katkılı KNT üzerine adsorbe edilip optimize edilen azot oksit için yapısal parametreler.

bağ uzunlukları (Å)										
		N-O Titresim								
Yapılar	${\rm U}_{ m M-C}{ m 1}$	U_{M-C}^2	U _{M-C} ³	U _{N-O} ⁴	Frekansı (cm ⁻¹)					
Ni-KNT	1,875, 1,893, 1,792	1,898, 1,910, 1,787	2,306	1,156	1916,0					
Pd-KNT	1,988, 1,988, 1,946	2,051, 2,046, 1,931	2,120	1,168	1707,9					
Pt-KNT	2,014, 2,017, 1,897	2,081, 2,085, 1,929	1,878	1,184	1725,0					

¹ metal atomu ile karbon nanotüpteki en yakın 3 karbon atomlarının uzaklığı adsorpsiyon öncesi
²metal atomu ile karbon nanotüpteki en yakın 3 karbon atomlarının uzaklığı adsorpsiyon sonrası
³metal atomu ile karbon nanotüp üzerinde adsorplanan azot oksit molekülünün uzaklığı

⁴ adsorpsiyon sonrası NO molekülünün bağ uzunluğu.

⁵ölçeklendirme faktörü, 0,9613 olarak kullanılmıştır[103].

Çizelge 4.2 : Metal atomları ile en yakın üç C atomunun adsorpsiyon öncesi ve sonrası açı değerleri.

Yapılar	Adsorpsiyon öncesi (°)	Adsorpsiyon sonrası(°)				
Ni-KNT	96, 98,4, 94,1	81, 92,7, 92,7				
Pd-KNT	75,6, 95,1, 95,1	83,3, 90,5, 89,7				
Pt-KNT	90, 94,3, 93,6	81,6, 86,2, 86,9				

Metal katkılı her KNT yapısının NO molekülü ile etkileşimini anlayabilmek için adsorpsiyon hesapları yapıldı. Adsorpsiyon öncesi bu yapıların ve NO molekülünün konumları şekil 4.2'de gösterilmiştir.SPE hesaplarını yapabilmek için NO molekülü ile metal yüklü KNT yapıları birlikte spin değerleri çiftli olarak elde edildi.







Şekil 4.2 :Adsorpsiyon öncesi; Ni katkılı KNT üzerine a) nitrojen tarafından yaklaştırılmış NO molekülü, b) oksijen tarafından yaklaştırılmış NO molekülü, Pd katkılı KNT üzerine c) nitrojen tarafından yaklaştırılmış NO molekülü, d) oksijen tarafından yaklaştırılmış NO molekülü, pt katkılı KNT üzerine e) nitrojen tarafından yaklaştırılmış NO molekülü, f) oksijen tarafından yaklaştırılmış NO molekülü.

Bulunan değerler ile optimizasyon yapılarak geometrileri elde edildi ve gerekli hesaplamalar yapıldı. Elde edilen geometriler şekil 4.3'de gösterilmiştir.







Şekil 4.3 :Adsorpsiyon sonrası; Ni katkılı KNT üzerine a) nitrojen tarafından yaklaştırılmış NO molekülü, b) oksijen tarafından yaklaştırılmış NO molekülü, Pd katkılı KNT üzerine c) nitrojen tarafından yaklaştırılmış NO molekülü, d) oksijen tarafındanyaklaştırılmış NO molekülü, Pt katkılı KNT üzerine e) nitrojen tarafından yaklaştırılmış NO molekülü, f) oksijen tarafından yaklaştırılmış NO molekülü.

Adsorpsiyon sonrası, konfigürasyonların Termal enerji, entalpi ve Serbest gibbs enerjileri elde edildi. Bu enerjilerin karşılaştırılmalı grafiği çizelge 4.3'te gösterilmiştir. Bu hesaplanan verilere göre nikel katkılı KNT yapısına oksijen tarafından yaklaştırılan NO adsorpsiyonu için enerji değerleri daha düşüktür. Platin ve paladyum katkılı KNT yapılarında ise durum tam tersidir. Bu yapılara nitrojen tarafından yaklaştırılan NO adsorpsiyonu için toplam enerji değerleri daha düşüktür.

Metal katkılı KNT	Thermal ene	rji (kcal/mol)	Termal ental	pi(kcal/mol)	Gibbs serbest enerjisi(kcal/mol)		
vanilari	Ν	0	Ν	0	Ν	O tarafından	
yapıları	tarafından	tarafından	tarafından	tarafından	tarafından		
Ni-KNT	-1888725.2	-1888779.2	-1888724.6	-1888778.6	-1888786.6	-1888839.7	
Pd-KNT	-1862088.8	-1862056.3	-1862088.2	-1862055.7	-1862149.3	-1862118.9	
Pt-KNT	-1857334.7	-1857322.4	-1857334.1	-1857321.8	-1857395.9	-1857383.0	

Çizelge 4.3 : Metal yüklü KNT yapılarının sahip oldukları toplam termal enerji, termal entalpi ve Gibbs serbest enerjisi.

*kalın yazılı enerji değerleri daha düşük enerji değerine sahip olup, konfigürasyon olarak seçilen yapılardır

Yukarıda ki çizelge 4.3'te görüldüğü gibi yapıların nitrojen ve ya oksijen tarafından metal katkılı karbon naotüplere yaklaştırıldıktan sonra, adsorpsiyon meydana gelmiştir. Bu yapılar minimum enerjili geometrileri olan; Ni-KNT için oksijen, Pd-KNT ve Pt-KNT için nitrojen tarafından yakınlaşan konfigürasyonların hesaplamaları yapıldı.

Bu konfigürasyonlar için elde edilen relatif adsorpsiyon enerjisi, adsorpsiyon entalpi ve adsorpsiyon Gibbs serbest enerji değerleri ve bu konfigürasyon için geometrik parametreler çizelge4.4'de listelenmiştir. Relatif adsorpsiyon entalpi değerleri sırası ile Ni-CNT, Pd-CNT ve Pd-CNT yapılarında -57,6, -83,2, -82,7 kcal/mol olarak hesaplandı. Değerlerin negatif reaksiyonlar olması ekzotermik olduğu göstermistir.NO molekülünün N-O atomları arasındaki mesafe adsorpsiyon sonrası vine sırası ile 1,156, 1,168, 1,184 Å olarak elde edildi ve N-O molekülü germe modu için titreşim frekansı değerleri 1916,0, 1707,9, 1725 cm⁻¹ olarak hesaplanmıştır,NO molekülünün titreşim frekansının adsorpsiyon sonrası Pd-Pt katkılı karbon nanotülerde azalırken, Ni katkılı karbon nanotüpte arttığıı görülmüştür. Ni, Pd ve Pt katkılı TDKNT üzerindeki NO adsorpsiyonu için Gibbs serbest enerji değişimi (ΔG) -46,1, -72,1, -71 kcal/mol olarak hesaplandı. Bu değerlere göre Ni,Pd ve Pt katkılı karbon nanotüpler sıfırdan küçük relative gibbs serbest enerjiye sahip olup adsorpsiyon reaksiyonu kendiliğinden oluşabilmektedir. Hesaplanan adsorpsiyon enerji değerleri, -57,0,-82,6, -82,1 kcal/mol idi. Optimize edilmiş olan Ni, Pd, Pt katkılı KNT'lerde metal atomu ile metal atomu ile bağlanmış üç C atomu arasındaki hesaplanan mesafeler, 1,787-2,085 Å olarak elde edildi (çizelge 4.1). Beklendiği gibi, bu bağların uzunluğugenel olarak artmıştır.

ΔE ΔH ΔG Yapılar (kcal/mol) (kcal/mol) (kcal/mol) Ni-KNT -57,0 -57,6 -46,1 Pd-KNT -83,2 -82,6 -72,1**Pt-KNT** -82,1 -82,7 -71,0

Çizelge 4.4 :Metal katkılı KNT üzerine adsorbe edilip optimize edilen azot oksit için enerji değerleri.

Ayrıca, NO molekülünün adsorpsiyonundan önce ve sonra yük dağılımını anlamak için metal katkılı nanotüplerde Mulliken popülasyon analizi ve doğal bağ orbitali (Natural Bond Orbital-NBO) metodolojisi uygulandı. Ayrıca ek olarak doğal popülasyon analizi (Natural Population Analysis - NPA) analizi ile yük dağılımı hakkın bilgi edinildi. Çizelge 4.5 ve çizelge 4.6'da Ni,Pd, Pt katkılı (6,0) TDKNT yapıları adsorpsiyon öncesi ve sonraısırası ile Mulliken ve NBO analizi atom yüklerini göstermektedir.

A. 1	Ni-H	KNT	Pd-I	KNT	Pt-KNT		
Atomlar	Adsorpsiyon öncesi (e)	Adsorpsiyon sonrası (e)	Adsorpsiyon öncesi (e)	Adsorpsiyon sonrası (e)	Adsorpsiyon öncesi (e)	Adsorpsiyon sonrası (e)	
Metal	0,387	0,256	0,339	0,352	0,662	0,863	
C 9	-0,219	-0,190	-0,215	-0,170	-0,293	-0,241	
C 29	-0,253	-0,180	-0,215	-0,167	-0,283	-0,239	
C 31	-0,189	-0,164	-0,191	-0,183	-0,344	-0,330	
N-O toplam yükü	0	-0,091	0	-0,09	0	-0,449	

Çizelge 4.5 : Mulliken popülasyon analizi.

	Ni-H	KNT	Pd-I	KNT	Pt-KNT		
Atomlar	Adsorpsiyon öncesi (e)	Adsorpsiyon sonrası (e)	Adsorpsiyon öncesi (e)	Adsorpsiyon sonrası (e)	Adsorpsiyon öncesi (e)	Adsorpsiyon sonrası (e)	
Metal	0,583	0,401	0,355	0,421	0,610	0,253	
C 9	-0,174	-0,146	-0,204	-0,166	-0,150	-0,115	
C 29	-0,222	-0,179	-0,204	-0,070	-0,150	-0,107	
C 31	-0,015	-0,012	-0,260	0,076	-0,017	0,085	
N-O toplam yükü	0	-0,088	0	-0,067	0	-0,195	

Cizelge 4.6 : NBO atomik yük analizi.

Adsorpsiyon öncesi, Ni,Pd,Pt katkılı (6,0) karbon nanotüp yapılarında Mulliken ve NBO populasyon analiz sonuçlarına göre, en yüksek pozitif yükler sırasıyla Ni için 0.387 / 0.583, Pd için 0.339 / 0.355, ve Pt için 0.662 / 0.610e olarak metal atomlarındadır. En düşük negatif yükler, metal atomuyla bağlanmış üç karbon atomundadır. Mulliken ve NBO populasyon analiz sonuçlarına göre, Ni, Pd, Pt atomlarıyla bağlanmış üç karbon atomunun toplam yükleri sırasıyla Ni katkılı KNT için-0,661 / -0,411, Pd katkılı KNT için -0,621 / -0,668, ve Pt katkılı KNT için -0,92 / -0,317 e'dir. Ayrıca yapılarımız üzerine adsorbe edilmiş NO molekülünün toplam yükü adsorpsiyon 0'dır. NO molekülünün yapılar üzerindeki öncesi adsorpsiyonundan sonra, yine en yüksek pozitif yükler metal atomlarındadır ve Mulliken ve NBO populasyon analiz sonuçlarına göre sırası ile Ni için +0,256 / 0,401, Pd için +0.352 / 0.421 ve Pt atomu için +0,863 / 0,253 e olarak görüldmektedir. Metal atomlarının üzerineki pozitif yük değerleri artmıştır. Adsorpsiyon sonrası en düşük negatif yükler, metal atomuyla bağlanmış üç karbon atomundadır. Ni, Pd, Pt atomlarıyla bağlanmış üç karbon atomunun toplam yükleri sırasıyla -0,534 / -0,337, -0,52 / -0,16, -0,81 / -0,137e'dir. Ek olarak, yapı üzerindeki adsorbe edilmis NO molekülünün toplam yükü Ni, Pd, Pt katkılı karbon nanotüp yapılarında Mulliken ve NBO populasyon analiz sonuçlarına göresirasi ile -0,091 / -0.088, -0,09 / -0.067 ve -0.449 / -0.195 e'dir. Bu sonuçlar, karbon nanotüp yapıları üzerindeki Ni, Pd, Pt atomlarından, adsorbe olan NO molekülüne yük transferinin gerçekleştiğini göstermektedir.

Esas olarak yük aktarım işlemlerine dayalı bir etkileşimin olduğu bu sensör mekanizmasında, algılama malzemelerinin hem yük transferinde donör (verici) hem de akseptör (alıcı) olduğu bir sistemdir. Sensör mekanizması farklı gazlara maruz bırakıldığında, yük aktarma reaksiyonu algılayıcı malzemeler ve adsorbe edilmiş gazlar arasında farklı yük aktarma yönleri ve miktarları ile gerçekleşebileceği önceki çalışmlarda da gözlenmiştir[116].

Elektronların atom çevresindeki yerlerini, açısal momentumlarını ve enerjilerini elde edilmesini sağlayan Schrödinger denklemidir. Elektronun kendi ekseni çevresinde dönme hareketine spin hareketi denir. Bu değer iki yöne doğru olabileceği için iki değer alabilir. Spin kuantum sayısı alfa (ms = +1/2) ve beta (ms = -1/2) olarak adlandırılır[117]. Oluştural yapılardaki hesaplamalarda çift yönlü spin değeri çıkmıştır. Metal katkılı karbon nanotüp yapılarının kimyasal aktivitesi, HOMO ve LUMO enerji değerleri ve HOMO ve LUMO (HLG) arasındaki enerji boşluğu kullanılarak belirlenebilir. HOMO-LUMO boşluğu molekülün kimyasal sertliğini temsil eder.Sertlikteki artış, sistemin daha istikrarlı bir konfigürasyona doğru hareketinde artışlara neden olur[118]. HLG değeri büyüdükçe, elektron uyarımı için gereken enerji yükselir bu da elektronik yapının daha yüksek kararlılığına karşılık gelir [119].HOMO ve LUMO arasındaki enerji boşluğu küçük olduğunda, kimyasal reaktivite yüksektir [120,121]. Başka bir deyişle, daha küçük bir HLG değeri daha yüksek bir kimyasal reaktivite anlamına gelir. HOMO ve LUMO değerleri, kimyasal sertlik (η), kimyasal potansiyel (μ), elektronegatiflik (χ), elektrofiliklik (ω) ve HLG değerleri elde edildi ve hesaplanan sonuçlar tablo 4.7'de gösterildi. Metal katkılı KNT yapıları için, elektronegatiflik, elektrofiliklik, kimyasal potansiyel, kimyasal sertlik değerleri denklem 3.5 - 3.9 denklemlerine dayalı hesaplamalar yapılarak elde edildi. Ni katkılı TDKNT yapısında NO adsorpsiyonundan sonra, kimyasal sertlik ve HLG değerleri alfa spini için arttığı, beta spini için azaldığı elde edildi. Kimyasal potansiyeli alfa spini için azalırken, beta spini için artmıştır. Pd katkılı TDKNT yapısında NO adsorpsiyonundan sonra, kimyasal sertlik ve HLG değerleri yükselirken, kimyasal potansiyel değerlerinde düşüş olduğu gözlemlendi. Pt katkılı TDKNT yapısında NO adsorpsiyonundan sonra, kimyasal sertlik, HLG ve kimyasal potansiyel verilerinin azaldığı hesaplandı.

Çizelge 4.7 : Ni, Pd, Pt katkılı TDKNT(6,0) yapıları için HOMO ve LUMO enerjisi, kimyasal sertlik, kimyasal potansiyel, elektronegatiflik, HLG (HOMO ile LUMO arasındaki enerji boşluğu) değerleri.

Yapılar		Nİ-TDKNT			Pd-TDKNT			Pt-TDKNT					
		Adsorj Önd Ni-TI (kcal/	psiyon cesi OCNT /mol)	Adsor Son NO TDF (kcal	psiyon Irası /Ni- KNT /mol)	Adsorj Önd Pd-TI (kcal	psiyon cesi OKNT /mol)	Adsor Son NO TDI (kcal	psiyon rası /Pd- KNT /mol)	Adsorj Önd Pt-TE (kcal/	psiyon cesi DKNT /mol)	Adsor Son NO TDI (kcal	psiyon ırası /Pt- KNT /mol)
		Alfa	Beta	Alfa	Beta	Alfa	Beta	Alfa	Beta	Alfa	Beta	Alfa	Beta
I	-еНОМО	134,1	150,2	141,8	127,6	137,4	123,4	141,9	144,3	131,1	146,3	140,4	141,1
А	−εLUMO	35,8	46,2	36,9	40,9	35,7	32,1	33,6	376	32,6	46,3	45,8	55,8
HLG	HOMO- LUMO	98,3	103,9	104,9	86,7	101,7	91,4	108,3	106,6	98,5	100,0	94,6	85,3
Kimyasal Sertlik (η)	(I – A) /2	49,2	51,9	52,5	43,4	50,9	45,7	54,1	53,3	49,2	50,0	47,3	42,6
Kimyasal Potansiyel (μ)	-(I+A)/2	-84,9	-98,2	-89,4	-84,2	-86,6	-77,8	-87,8	-90,9	-81,8	-96,3	-93,1	-98,4
Elektro- negatiflik (X)	(I + A)/2	84,9	98,2	89,4	-84,2	86,6	77,8	87,8	90,9	81,8	96,3	93,1	98,4

Ni, Pd ve Pt katkılı (6,0) TDKNT yapılari ve NO adsorbe edilmiş yapıların HOMO ve LUMO gösterimleri sırası ile Şekil 4.4, Şekil 4.5, Şekil 4.6'da gösterilmektedir.



Şekil 4.4 :Ni-TDKNT üzerinde NO adsorpsiyonu öncesi ve sonrası, alfa ve beta olarak HOMO-LUMO gösterimleri.

Yapılar	Adsorpsiyon Öncesi	Adsorpsiyon Sonrası
	HOMO-ALFA	HOMO-ALFA
	HOMO-BETA	НОМО-ВЕТА
JKNT TDKNT		
Pd-FD	LUMO-ALFA	LUMO-ALFA
Ŋ		
	LUMO-BETA	LUMO-BETA

Şekil 4.5 : Pd-TDKNT üzerinde NO adsorpsiyonu öncesi ve sonrası, alfa ve beta olarak HOMO-LUMO gösterimleri.



Şekil 4.6 :Pt-TDKNT üzerinde NO adsorpsiyonu öncesi ve sonrası, alfa ve beta olarak HOMO-LUMO gösterimleri.

$$\sigma = AT^{3/2} exp\left(\frac{-E_g}{2kT}\right) \tag{4.1}$$

Burada σ ifadesi elektriksel iletkenliktir, A değeri ise sabittir (elektron/m³K^{3/2}), E_g değeri HOMO-LUMO boşluğu (HLG), k Boltzmann sabiti ve T sıcaklıktır.

Bu denklem ile uyumlu olarak belirli bir sıcaklık için daha küçük HLG, daha büyük elektriksel iletkenlik demektir. Daha önce yapılan çalışmalarda da bu ilişkinin deneysel sonuçlarla iyi bir uyum içinde olduğu bildirilmiştir[122].

Sonuç olarak, NO molekülünün adsorpsiyonunun Pt dekore edilmiş (6,0) TDKNT yapısının elektriksel iletkenliğini arttırdığı sonucuna varılabilir ve bu Pt dekore edilmiş (6,0) TDKNT yapısının NO molekülü için potansiyel bir sensör olabilceğini göstermektedir[123,85].

Ni, Pd, Pt ile dekore edilmiş TDKNT ve CO ile adsorbe edilmiş Ni, Pd, Pt TDKNT yapılarının DOS (density of state) durum yoğunluğu grafikleri, Şekil 4.7'de sunulmuştur. Şekil 4.7'de görüldüğü gibi, Ni ve Pd katkılı (6,0) KNT'de HOMO-LUMO boşluğunun arttığı, Pt katkılı (6,0)KNT'de ise HOMO-LUMO boşluğunun azaldığı çizilen DOS grafiklerinde de görülmektedir

Metal katkılı (6,0) KNT yapılarının ve NO adsorbe edilmiş metal katkılı (6,0) KNT yapılarının elektrostatik potansiyel (ESP) dağılım grafikleri, Şekil 4.8'de gösterilmiştir. Grafikler, elektron yoğunluğunun yüzey dağılımına göre çizimleridir. Elektrostatik potansiyel, renkler ile ifade edilerek, mavi> yeşil> sarı> kırmızı sıralaması ile elektrostatik potansiyel azalır [124,125].





Şekil 4.7: Ni-TDKNT a) adsorpsiyon öncesi b) adsorpsiyo sonrası, Pd-TDKNT c) adsorpsiyon öncesi d) adsorpsiyo sonrası, Pt-TDKNT e) adsorpsiyon öncesi f) adsorpsiyo sonrası DOS grafikleri.

-5.0

-2.5

0.0

-7.5

-1 -20.0

-17.5 -15.0

-12.5

5 –10.0 Energy (eV) -1 -20.0

-17.5

-15.0

-12.5

–10.0 Energy (eV)

-7.5

-5.0

-2.5

0.0

Şekil 4.8'de gösterildiği gibi, mavi elektron bulutu adsorpsiypon öncesi her üç yapı için de metal atomunun etrafındadır. Benzer şekilde, NO molekülünün adsorpsiyonundan sonrası Ni katkılı KNT yapısında sarı bulutlar ve hafif kırmızı bulutlu bölge metal atomuna bağlı üç karbon çevresindedir. Pd katkılı KNT yapısında sarı bulutlar, Pd atomu ile bağlı üç karbon atomunun ve NO molekülünün O atomu etrafında bulunur. Pt katkılı KNT yapısında NO molekülü çevresinde yoğun kırmızı bulut elektronca zengin bölgeyi göstermektedir. Diğer yapılara göre bu bölgenin daha kırmızı olma sebebi nitrojen atomunun da negatif yüklü olmasıdır. Yine sarı bulutlar metal atomuna bağlı üç karbon atomu çevresindedir. Mavi renkli bölgeler, elektron eksikliği olan bölgeleri gösteren Ni, Pd ve Pt atomları çevresindedir.



8 12375757 12555555 125555555

c)

e)









Şekil 4.8 : Ni-TDKNT a) adsorpsiyon öncesi b) adsorpsiyo sonrası, Pd-TDKNT c) adsorpsiyon öncesi d) adsorpsiyo sonrası, Pt-TDKNT e) adsorpsiyon öncesi f) adsorpsiyo sonrası ESP grafikleri.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

5.1 Sonuçlar

Bu çalışmada, NO gaz sensörünün kullanımını araştırmak amacıyla nikel, paladyum, platin katkılı CNT (6,0) yapıları için WB97XD yöntemiyle DFT hesaplamaları kullanılmıştır. Yapısal ve elektronik özelliklerin detaylı analizi hem Ni-KNT, Pd-KNT ve Pt-KNT yapıları hem de NO adsorbe edilmiş Ni-KNT, Pd-KNT ve Pt-KNT yapıları için yapılmıştır.

NO molekülü karbon nanotüp üzerindeki metal atomunun üzerine hem N hem de O tarafından yerleştirilerek kuantum kimyasal hesaplamalar yapılmıştır. Sistemin tercih edeceği minimum enerjili konfigürasyon, Ni-TDKNT için O tarafından yakınlaşan NO adsorpsiyonu iken, Pd–TDKNT ve Pt-TDKNT yapıları için N tarafından yakınlaşan NO adsorpsiyonu içindir. Relatif adsorpsiyon enerji değerleri sırası ile Ni-CNT, Pd-CNT ve Pd-CNT yapılarında sırasıyla -57,0, -82,6 ve-82,1 kcal/mol olarak hesaplanmıştır.Yük dağılımı KNT yapısının Ni, Pd ve Pt atomlarından elektron verici olarak, adsorbe edilen NO molekülüne aktarıldığını göstermektedir.

NO adsorpsiyonu hesaplamalarından sonra Ni, Pd ve Pt katkılı karbon nanotüplerde kimyasal sertlik, kimyasal potensiyel ve HLG (HOMO-LUMO gap) değerlerindeki farklılıklar incelendi. Ni katkılı TDKNT yapısında, kimyasal sertlik ve HLG değerleri alfa spini için arttığı, beta spini için azaldığı elde edildi. Kimyasal potansiyeli alfa spini için azalırken, beta spini için artmıştır. Pd katkılı TDKNT yapısında NO adsorpsiyonundan sonra, kimyasal sertlik ve HLG değerleri yükselirken, kimyasal potansiyel değerlerinde düşüş olmuştur. Pt katkılı TDKNT yapısında NO adsorpsiyonundan sonra, kimyasal sertlik, HLG ve kimyasal potansiyel verilerinin azaldığı hesaplanmıştır.HLG değeri kimyasal kararlılık ve reaktivite hakkında önemli bilgi vermektedir. HOMO ve LUMO enerji boşluğu ne kadar yakınsa etkileşim o kadar kolay olmaktadır. Bu çalışmada elde edilen sonuçlara dayanarak, NO molekülünün Pt-TDKNT bölgesinde adsorbe edilebileceği,

büyük adsorpsiyon enerjisine sahip Pt-C bağının oluşturulması ve önemli yük transferinin oluştuğu sonucuna varılmıştır. HLG değerlerindeki düşüş nikel ve paladyumkatkılıkarbon nanotüp yapılarının NO sensörü olarak kullanılabilirliği konusunda olumsuz sonuç çıkartmıştır.

Sonuç olarak, Pt katkılı (6,0) TDKNT oda sıcaklığında azot oksit algılama potansiyeli vardır.

5.2 Öneriler

Bu çalışmada NO adsorpsiyonu nikel, paladyum ve platin katkılı TDKNT (6,0) yapısının üzerinde kuantum kimyasal yöntemlerle teorik olarak çalışılmıştır. Çok çeşitli özelliklere sahip olan karbon nanotüplerin farklı elektronik iletkenliğe sahip oryantasyonu ya da farklı ebatlarda tek duvarlı ve çok duvarlı bir karbon nanotüp kullanılarak bu hesaplamalar çoğaltılabilir.

Nikel, paladyum ve platin metalleri kullanılan yapılar üzerinde farklı atomlar kullanılarak azot oksit algılama potansiyeli olan karbon nanotüpler elde edilebilir.

Son olarak bu çalışmada hesaplanan yüzey modelleri ve ya çalışılacak olan farklı oryantasyonları deneysel olarak da elde edilerek adsorpsiyon çalışması gerçekleştirilebilir.

KAYNAKLAR

[1] Pollutant Information: Nitrogen Oxides. Erişim: 9 Eylül 2019, Https://Naei.Beis.Gov.Uk/Overview/Pollutants?Pollutant_İd=6

[2]GothenburgProtocol.Erişim:9Eylül2019,Http://Www.Unece.Org/Environmental-
Policy/Conventions/Envlrtapwelcome/Guidance-Documents-And-Other-
Methodological-Materials/Gothenburg-Protocol.Html9Eylül

[3] Daley, R.&Daley, S.(2011). Organic Chemistry, Lulu Pub, Raleigh, 3, 1078.

[4] Mcmichael, A.J.&Overload P.(1993). Planetary Overload.Cambridge University Press, New York.

[5] Mcmichael, A.J.&Overload P.(1993).Carbon The Black, The Gray And The Transparent. Cambridge University Press, New York: Springer.

[6] Physical And Chemical Properties Of Carbon Nanotubes. Erişim: 8 Eylül 2019, Http://Www.İssp.Ac.Ru/Ebooks/Books/Open/Physical_And_Chemical_Propert ies_Of_Carbon_Nanotubes.Pdf

[7] Heat Conducting Graphene Could Cool Electronics. Erişim 8 Eylül 2019, Https://Newatlas.Com/Heat-Conducting-Graphene-Could-Cool-Electronics/15309/

[8] Ut Contributes To Study On Graphene İnterface Properties, Stretchable PolymerSubstrate. Erişim 8 Eylül 2019,Https://Bionews-Tx.Com/News/2013/08/11/Ut-Contributes-To-Study-On-Graphene-İnterface-Properties-Stretchable-Polymer-Substrate/

[9] Sahu, C., Samantara, K., Mohanta, J., Jena, B., Si, S. (2015). Graphene: Synthesis, Properties And Application, 5.

[10] Pandey, P.&Dahiya, M.(2016). Carbon Nanotubes: Types, Methods Of Preparation And Applications, International Journal Of Pharmaceutical Science And Research, 1, 4, 15-21.

[11] Dresselhaus, M.S., Dresselhaus, G. And Saito, R.(1998). Physical Properties Of CarbonNanotubes, World Scientific Publishing Company.

[12] Charlier J.-C., Blase X., Roche S. (2007). Electronic And Transport Properties Of Nanotubes, Reviews Of Modern Physics, 79.

[13] Özgür, I.Nanotüp Ve Nanotel Yapılarının XRD İle Karakterizasyonu(Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

[14] Hamada N., Sawada S.-I., Oshiyama A.(1992). New One-Dimensional Conductors: Graphitic Microtubules, Physical Review Letters, 68, 10.

[15] Mintmire J.W., Dunlap B.I., White C.T.(1992). Are Fullerene Tubules Metallic?, Phys. Rev. Lett., 68, 631-34.

[16] Saito R., Fujita M., Dresselhaus G., Dresselhaus M.(1992). Electronic Structure Of Chiral Graphene Tubules, Appl. Phys. Lett., 60, 6.

[17] Dresselhaus M.S., Dresselhaus G., Jorio A.(2004). Unusual Properties And Struc- Ture Of Carbon Nanotubes, Annu. Rev. Mater. Res., 34, 247-78.

[18] Mamalis A.G., Vogtländer L.O.G., Markopoulos A.(2004). Nanotechnology And Nanostructured Materials: Trends İn Carbon Nanotubes, Precision Enğineering, 28, 16–30.

[19] Periyodic Table Of Carbon Nanotubes. Erişim: 8 Eylül 2019, Https://Quantumwise.Com/Documents/Cnt_Periodictable.Pdf

[20] Klumpp C, Kostarelos K, Prato M, Bianco A.(2006). Functionalized Carbon Nanotubes As Emerging Nanovectors For The Delivery Of Therapeutics, Biochem Biophys Acta, 1758, 404-412.

[21] Dresselhaus M.S., Dresselhaus G., Jorio A.(2004). Unusual Properties And StrucTure Of Carbon Nanotubes, Annu. Rev. Mater. Res., 34, 247-78.

[22] Maultzsch J. (2004). Vibrational Properties Of Carbon Nanotubes And Graphite. (Doktora Tezi). Technischen Universität Berlin, Fakultät II Mathematik Und Naturwissenschaften, Germany.

[23] Sinnot S.B. Ve Andrews R. (2001). Carbon Nanotubes: Synthesis, Properties,

And Applications, Crit. Rev. Solid State Mater. Sci., 26(3), 145-249.

[24] Gao G., Cagin T. And Goddard W.A.(1998). Energetics, Structure, Mechanical And Vibrational Properties Of Single-Walled Carbon Nanotubes, Nanotechnology, 9, 184-191.

[25] Kelvii, B., Wei Guo, K., Tam, H. (2015). Tem Morphology Of Carbon Nanotubes (Cnts) And Its Effect On The Life Of Micropunch, The Transmission Electron Microscope – Theory And Applications.

[26] Single Wall Carbon Nanotubes. Erişim: 8 Eylül 2019, Https://Www.Nano-Lab.Com/Single-Walled-Carbon-Nanotubes.Html

[27] Mauron P.(2003). Growth Mechanism And Structure Of Carbon. (Doktora Tezi). Nanotubes, Mathematisch Naturwissenschaftlichen Fakultät, Universität Freiburg, Switzerland.

[28]Sun X., Kiang C.-H., Endo M., Takeuchi K., Furuta T., Dresselhaus M. S.(1996). Stacking Characteristics Of Graphene Shells In Carbon Nanotubes, Physical Review B, 54, 18.

[29] Chen P., Lin K. Ve Tan K.L. (2000). Carbon Nanotubes: A Future Material Of Life, Iubmb Life, Cilt 49, Sf. 105-108.

[30] Kuchibhatla S.V.N.T., Karakoti A.S., Bera D., Seal S.(2007). One Dimensional Nanostructured Materials, Progress In Materials Science 52 699-913.

[31] Li,W-W. Ji,W-M., Yi, Liu, Y., Xing, F., Liu, Y.(2015). Damping Property Of A Cement-Based Material Containing Carbon Nanotube, Journal Of Nanomaterials, 2015, 7.

[32] Alarifi, S.&Ali, D.(2015).Mechanisms Of Multi-Walled Carbon Nanotubes– Induced Oxidative Stress And Genotoxicity İn Mouse Fibroblast Cells,International Journal Of Toxicology, 34(3) 258-265.
[33] Harris, B. & Bunsell, A.R. (1977). Structure And Properties Of Engineering Materials, New York, Mcgraw-Hill.

[34] Salvetat, J.P., Bonard, J.M., Thomson, N.H., Kulik, A.J., Forr'O, L., Benoit, W., Zuppiroli, L.(1999).Mechanical Properties Of Carbon Nanotubes, Applied Physics A, 69(3), 255–260.

[35] Ashby, M.F. (1989). Overview No. 80: On The Engineering Properties Of Materials, Acta Metallurgica, 37(5), 1273-1293.

[36] Karbon Nanotüpler: Özellikler Ve Uygulamalar. Eişim: 8 Eylül 2019, Https://Grafen.Com.Tr/Pdf/1459186118.Pdf

[37] Mamalis, A.G., Vogtländer, L.O.G., Markopoulos, A.(2004). Nanotechnology And Nanostructured Materials: Trends İn Carbon Nanotubes , Precision Engineering, 28, 16-30.

[38] Hone, J.(2004). Carbon Nanotubes: Thermal Properties ,Columbia University, New York, Dekker Encyclopedia Of Nanoscience And Nanotechnology.

[39] Eatemadi, A., Daraee, H., Karimkhanloo, H., Kouhi, M., Zarghami, N., Akbarzadeh ,A.(2014). Carbon Nanotubes: Properties, Synthesis, Purification, And Medical Applications, Nanoscale Res Lett., 9(1),1-13.

[40] Jan, P., Jana , D., Jana, C., Hubalek, J., Jasek, O., Adam, V.(2011). Methods For Carbon Nanotubes Synthesi, J Mater Chem., 21, 15872-15879.

[41] Bethune, D.S., Kiang, C.H., De Vries, M.S., Gorman, G., Savoy, R., Vasquez, J. (1993). Cobalt-Catalysed Growth Of Carbon Nanotubes With Single Atomic Layer Walls, Nature, 363(6430), 605-607.

[42]. Bhushan, B.(2004).Springer Handbook Of Nanotechnology, Heidelberg, Springer-Verlag Berlin,

[43] Takikama, H., Kusano, O., Sakakibara, T.(1999). Graphite Cathode Spot Produces Carbon Nanotubes İn Arc Discharge, Appl. Phys., 32(2), 2433-2437.

[44] Sun, X.(2007).Synthesis Of High Quality Single Walled Carbon Nanotubes By ArcDischarge Method İn Large Scale, Science Direct, 61(18), 3956-3958.

[45] Yudasaka, M., Yamada, R., Sensui, N., Wilkins, T., Ichihashi, T., Iijima, S.(1999). Mechanism Of The Effect Of Nico, Ni And Co Catalysts On Th Yeld Of Single Wall Carbon Nanotubes Formed By Pulsed Nd:Yag Laser Ablation, J. Phys. Chem. B, 103, 6224–6229.

[46] Yudasaka, M., Sensui, N., Takizawa, M., Bandow, S., Ichihashi, T., Iijima, S. (1999). Formation Of Single Wall Carbon Nanotubes Catalyzed By N Separation From Y İn Laser Ablation Or İn Arc Discharge Using A C Target Containing A Niy Catalyst, Chem.Phys. Lett., 312, 155–160.

[47] Zhang, M., Yudasaka, M., Iijima, S. (2001).Single Wall Carbon Nanotubes: A High Yield Of Tubes Through Laser Ablation Of A Crude-Tube Target, Chem. Phys. Lett., 336, 196–200.

[48] Guo, T., Nikolaev, P., Thess, A., Colbert, D. T., Smalley, R. E. (1995). Catalytic Growth Of Single Walled Nanotubes By Laser Ablation, Chem. Phys. Lett., 243, 49–54.

[49] Zhang, H., Ding, Y., Wu, C., Chen, Y., Zhu, Y., He, Y., Zhong, S.(2003). The Effect Of Laser Power On The Formation Of Carbon Nanotubes Prepared İn Co2 Continuous Wave Laser Ablation At Room Temperature, Physica B, 325, 224–229.

[50] Burakov, V. S., Bokhonov, A. F., Nerdel'ko, M. I., Savastenko, N. A.And Tarasenko, N. V. (2003).Optical Emission Characteristics Of Carbon Plasma Produced By Single And Double Pulse Laser Ablation, Institute Ofmolecular And Atomic Physics National Academy Of Science Of Belarus, 4.

[51] Yudasaka, M., Komatsu, T., Ichihashi, T., Iijima, S.(1997).Single Wall Carbon Nanotube Formation By Laser Ablation Using Double -Targets Of Carbon And Metal, Chem. Phys. Lett., 278, 102–106.

[52] Arepalli, S., Nikolaev, P., Holmes, W., Scott, C. D. (1999).Diagnostic Of Laser-Produced Plume Under Carbon Nanotube Growth Conditions, Appl. Phys. A, 69,1–9.

[53] Scott, C. D., Arepalli, S., Nikolaev, P., Smalley, R. E. (2001).Growth Mechanisms For Single Wall Carbon Nanotubes In A Laser Ablation Process, Appl. Phys. A, 72, 573–580.

[54] Ren Z. F., Huang, Z. P., Xu, J. W., Wang, J. H., Bush, P., Siegal, M. P., Provencio, P. N.(1998). Synthesis Of Large Arrays Of Well-Aligned Carbon Nanotubes On Glass, Science, 282(5391), 1105-1107.

[55] Ren Z. F., Huang, Z. P., Xu, J. W., Wang, J. H., Bush, P., Siegal, M. P., Provencio, P. N.(1999). Growth Of A Single Freestanding Multiwall Carbon Nanotube On Each Nanonickel Dot. Applied Physics Letters; 75(8),1086–1088.

[56] Ren Z. F., Huang, Z. P., Xu, J. W., Wang, J. H., Bush, P., Siegal, M. P., Provencio, P. N.(1998). Growth Of Highly Oriented Carbon Nanotubes By Plasma Enhanced Hot Filament Chemical Vapor Deposition. Applied Physics Letters;73(26):3845–7.

[57] Yudasaka, M. (1995). Specific Conditions For Ni Catalyzed Carbon Nanotube Growth By Chemical Vapor Deposition, Appl. Phys. Lett., 67, 2477.

[58] Yudasaka, M. (1997). Nitrogen-Containing Carbon Nanotube Growth From Ni Phthalocyanine By Chemical Vapor Deposition, Carbon, 35, 195-201.

[59] Iijima, S.(1991). Helical Microtubules Of Graphitic Carbon, Nature, 354, 56-58.

[60] Kong, J., Franklin, N.R., Zhou, C., Chapline, M.G., Peng, S., Cho, K., Dai, H. (2000)..Nanotube Molecular Wires As Chemical Sensors, Science, 287, 622–625.

[61] Collins, P.G., Bradley, K., Ishigami, M., Zettl, A. (2000).Extreme Oxygen Sensitivity Of Electronic Properties Of Carbon Nanotubes, Science, 287, 1801-1804.

[62] Kauffman, D.R., Star, A. (2008).Carbon Nanotube Gas And Vapor Sensors, Angewandte Chemie International Edition, 47, 6550–6570.

[63] Snow, E.S., Perkins, F.K., Robinson, J.A.(2006).Chemical Vapor Detection Using Singlewalled Carbon Nanotubes, Journal Of The American Chemical Society, 35, 790–798.

[64] Dai, H. (2002).Carbon Nanotubes: Synthesis, Integration, And Properties, Accounts Of Chemical Research, 35, 1035-1044.

[65] Liu, S., Shen, Q., Cao, Y., Gan, L., Wang, Z., Steigerwald, M. L., Guo, X.(2010). Chemical Functionalization Of Single-Walled Carbon Nanotube Field-Effect Transistors As Switches And Sensors, Coordination Chemistry Reviews, 254, 1101-1116.

[66] Susi, T., Hardcastle, T.P., Hofsäss, H., (...), Meyer, J.C., Kotakoski, J.(2017). Single-Atom Spectroscopy Of Phosphorus Dopants Implanted Into Graphene, 2d Materials 4, 2.

[67] Jiang, K., Back, S., Akey, A.J., Xia, C., hu, Y., Liang, W., Schaak, D., Stavitski, E., Norskov, J.K., Siahrostami, S., Wang, H.(2019). Highly Selective Oxygen Reduction To Hydrogen Peroxide On Transition Metal Single Atom Coordination, Nature Communications. 10, 3997.

[68] Delmas R., Serça D. (1997). Global Inventory Of Nox Sources, Nutrient Cycling In Agroecosystems, 48 (1-2), 51-60.

[69] Hava Kalitesi Değerlendirme Ve Yönetimi Yönetmeliği.(2008). T. C. Resmi Gazete,26898, 8 Eylül 2019.

[70] Atkinson, R. (2000). Atmospheric Chemistry Of Vocs And Nox, Atmospheric Environment, 34, 2063–2101.

[71] Zhang, D., Liu, Z., Li, C., Tang, T., Liu, X., Han, S., Lei, B., Zhou, C. (2004). Detection Of No2 Down To Ppb Levels Using Individual And Multiple In2o3 Nanowire Devices, Nano Letters, 4, 1919–1124.

[72] Panchakarla,L.S, Subrahmanyam, K.S., Saha, S.K., Govindaraj, A., Krishnamurthy, H.R., Waghmare, U.V., Rao C.N.R, (2009).Synthesis, Structure, And Properties Of Boron- And Nitrogen-Doped Graphene, Advanced Materials, 21, 4726–4730.

[73] Luo, H., Meng, R., Gao, H., Sun, X., Xiao, J., Ye, H., Zhang, G., Chen, X. (2017). First-Principles Study Of Nitric Oxide Sensor Based On Blue Phosphorus Monolayer, Ieee, 38, 1139 – 1142.

[74] Chatterjee, S.G., Dey, S., Samanta, D., Santra, S., Chatterjee, S., Guha, P.K., Chakraborty, A.K. (2018). Near Room Temperature Sensing Of Nitric Oxide Using Sno2/Ni Decorated Natural Cellulosic Graphene Nanohybrid Film, Journal Of Materials Science Materials In Electronics, 29, 20162–20171.

[75]Tsai, T., Chang, S.J., Ji, L.W., Hsiao, Y.J., Tang, I.T., Lu, H.Y., Chu, Y.L. (2018). High Sensitivity Of No Gas Sensors Based On Novel Ag-Doped Zno Nanoflowers Enhanced With A Uv Light-Emitting Diode, American Chemical Society,3(10),13798-13807.

[76] Chatterjee, G.S., Dey, S., Samanta, D., Santra, S., Chatterjee, S., Guha, P. K., Chakraborty, A. K. (2018). Near Roomtemperaturesensing Of Nitricoxideusing Sno₂/Ni-Decorated Natural Cellulosic Graphene Nanohybrid Film, Journal Of Materials Science: Materials In Electronics, 29(23), 20162–20171.

[77] Donker, N., Ruchets, A., Kamin, D., Zosel, J., Guth, U., Moos, R.(2019).Influence Of Polarization Time Andpolarizationcurrent Of Pt/Ysz-Based No Sensors Utilizing The Pulsed Polarization When Applying Constant Charge, Sensors And Actuators B: Chemical, 290, 28-33.

[78] Hu, H., Yang, X., Guo, X., Khaliji, K., Biswas, S., Abajo D., Low, T., Sun, Z. (2019). Gas Identification With Graphene Plasmons, Nature Communications ,10,1131.

[79] Yoosefian, M., Zahebl, M., Mola, A., Naserian, S.(2015). A Dft Comparative Study Of Single And Double So2 Adsorption On Pt-Doped And Au-Doped Single-Walled Carbon Nanotube, Applied Surface Science, 349, 864-869.

[80] Shi, K.-Y., Li, L., Yang, Y., Jin, X.-Q., Shao, S.-Z., Wang, H.-Y., Fu, H.-G. (2006).Per Chemical Modified Muli-Walled Carbon Nanotubes And No Adsorption Behavior", Harbin Gongye Daxue Xuebao/Journal Of Harbin Institute Of Technology, 38, 2199-2202.

[81] Li, L.&Shi, K.-Y. (2009). No Adsorption Of Mwents Modified By B-Cyclodextrin, Cailiao Kexue Yu Gongyi/Material Science And Technology, 17, 675-679.

[82] Zhang, J., Boghossian, A. A., Barone, P. W., Rwei, A., Kim, J., Lin, D., Heller, D.A., Hilmer, A.J., Nair, N., Reuel, N.F., Strano, M.S. (2011). Single Molecule Detection Of Nitric Oxide Enabled By D(At)15 Dna Adsorbed To Near Infrared Fluorescent Single-Walled Carbon Nanotubes, Journal Of The American Chemical Society, 133, 567–581.

[83] Santillan-Jimenez, E., Crocker, M., Bueno-Lopez, A., Salinas-Martínez De Lecea, C. (2011). Carbon Nanotube-Supported Metal Catalysts For Nox Reduction Using Hydrocarbon Reductants: Gas Switching And Adsorption Studies, Industrial & Engineering Chemistry Research, 50, 7191–7200.

[84] Li, K., Wang, W., Cao, D. (2011). Novel Chemical Sensor For Co And No: Silicon Nanotube, Journal Of Physical Chemistry C, 115, 12015-12022.

[85] Li, K., Wang, W., Cao, D. (2011). Metal (Pd, Pt)-Decorated Carbon Nanotubes For Co And No Sensing", Sensors And Actuators B: Chemical, 159, 171-177.

[86] Vermisoglou, E.C., Romanos, G.E., Karanikolos, G.N., Kanellopoulos, N.K. (2011). Catalytic Nox Removal By Single-Wall Carbon Nanotube-Supported Rh Nanoparticles", Journal Of Hazardous Materials, 194j, 144-155.

[87] Sen, S., Sen, F., Boghossian, A.A., Zhang, J., Strano, M.S.(2013). Effect Of Reductive Dithiothreitol And Trolox On Nitric Oxide Quenching Of Single-Walled Carbon Nanotubes, The Journal Of Physical Chemistry, 117, 593–602.

[88] Ma, Z., Yang, H., Li, B., Liu, F., Zhang X. (2013).Temperature-Dependent Effects Of So2 On Selective Catalytic Reduction Of No Over Fe–Cu–Ox/Cnts–Tio2 Catalysts, Industrial & Engineering Chemistry Research, 52, 3708–3713.

[89] Liang, S.-Z., Chen, G., Harutyunyan, A.R., Cole, M.W., Sofo, J.O. (2013). Analysis And Optimization Of Carbon Nanotubes And Graphene Sensors Based On Adsorption-Desorption Kinetics, Applied Physics Letters, 103, 233108.

[90] Wang, R., Zhang, D., Liu, C. (2014). The Germanium-Doped Boron Nitride Nanotube Serving As A Potential Resource For The Detection Of Carbon Monoxide And Nitric Oxide", Computational Materials Science, 82, 361-366.

[91] Vasylenko, A. I. Tokarchuk, M. V. Jurga, S. (2015). Effect Of A Vacancy In Single-Walled Carbon Nanotubes On He And No Adsorption, The Journal Of Physical Chemistry, 119, 5113–5116.

[92] Du,J., Sun, X., Jiang, G. (2015). Adsorption Of The Ir4 Cluster On Single-Wall Carbon Nanotubes: The Zigzag Types Are More Suitable", Rsc Advances, 5, 60286–60293.

[93] Zhang, T., Wang, D., Gao, Z., Zhao, K., Gu, Y., Zhang, Y., He, D.(2016). Performance Optimization Of A Mno2/Carbon Nanotube Substrate For Efficient Catalytic Oxidation Of Low-Concentration No At Room Temperature, Rsc Advances, 6, 70261–70270.

[94] Liu, L., Jin, J., Hou, F., Li, S., Lee, C. (2017).Catalytic Effects Of Calcium And Potassium On A Curved Char Surface In Fuel Reburning: A First-Principles Study On The Adsorption Of Nitric Oxide On Single-Wall Carbon Nanotubes With Metal Decoration, Energy, 125, 459-469.

[95] Bochenkov, V. E., Sergeev, G. B.(2010). Sensitivity, Selectivity, And Stability Of Gas-Sensitive Metal-Oxide Nanostructures, Metal Oxide Nanostructures And Their Applications, 3, 31-52.

[96] Yunusa, Z., Hamidon, M.N., Kaiser, A., Awang, Z.(2013).Gas Sensors: A Review, Sensors & Transducers, 168(4), 61-75.

[97] Yang, S., Jiang, C., Wei, S.(2017).Gas Sensing In 2d Materials, Appl. Phys. Rev. 4, 021304.

[98] Kong, J. (2000). Nanotube Molecular Wires As Chemical Sensors. Sience 287, 622–625.

[99] Dekker, C., Tans, S. J., Verschueren, R. M. (1998). Room-temperature transistor based on a single carbon nanotube, Nature, 393(6680), 49–52.

[100] Martel, R., Schmidt, T., Shea, H. R., Hertel, T., Avouris, Ph. (1998).Single- and multi-wall carbon nanotube field-effect transistors, Applied Physics Letters. 73(17), 2447.

[101] Collins, P.G.; Avouris, P. (2000).Nanotubes for Electronics, Scientific American, 283 (6), 62–69.

[102] Alexander, S., Vikram, J., Sergei, S., David T., Jean-Christophe, P. G. (2006). Gas Sensor Array Based on Metal-Decorated Carbon Nanotubes, J. Phys. Chem., 110, 21014-21020.

[103] Kohn, W., Sham, L. J.(1965). Self-Consistent Equations Including Exchange And Correlation Effects, Phys. Rev. 140, 1133.

[104] J. Frisch, G.W. Trucks, H.B. Schlegel, G.E. Scuseria, M.A. Robb, J.R. Cheeseman, G., (2013). Gaussian, Inc., Wallingford Ct.

[105] Blaudeau, J.(1997). Extension Of Gaussian-2 (G2) Theory To Molecules Containing Third-Row Atoms K And Ca. J. Chem. Phys., 107, 5016–5021.

[106] Hay, P.J. And Wadt, W.R. (1985). Ab Initio Effective Core Potentials For Molecular Calculations. Potentials For K To Au Including The Outermost Core Orbitals. The Journal Of Chemical Physics, 82, 299-310.

[107] Susi, T., Hardcastle, T.P., Hofsäss, H., , Meyer, J.C., Kotakoski, J.(2017). Single-Atom Spectroscopy Of Phosphorus Dopants İmplanted İnto Graphene, 2d Materials, 4, 2. [108] Wong, M.W.(1996). Vibrational Frequency Prediction Using Density Functional Theory, Chem. Phys. Lett., 256, 391–399.

[109] Pearson, R. G. (1986). Absolute Electronegativity And Hardness Correlated With Molecular Orbital Theory, Proceeding Of The National Academiy Of Sciences 83, 8440-8441.

[110] Yang, W.&R.G. Parr.(1985).Hardness, Softness And The Fukui Function İn The Electronic Theory Of Metals And Catalysis, Proc. Natl. Acad. Sci.,82,6723-6726,.

[111] Asiri, A.A., Ersanli, C.C., Sahin, O., Arshad, M.N., Hameed, S.A. (2016). Molecular Structure, Spectroscopic And Quantum Chemical Studies Of 1'3,'3,'-Trimethylspiro[Benzo[F]Chromene-3,2'- İndoline, J. Mol. Struct1111, 108-117.

[112] Günay N., Pir H., Atalay Y. (2011). Yağış-Akış Modelinin Cbs Ve Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Uygulanması: Havran Çayı Örneği (Balıkesir), Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, 15-32.

[113] N. M. O'boyle, A. L. Tenderholt, K. M. Langner, J. Comp. Chem. (2008).29, 839. Http://Gausssum.Sourceforge.Net/

[114] Mulliken, R.S. (1955). Electronic Population Analysis On Lcao-Mo Molecular Wave Functions, J. Chem. Phys. 23 1833–1840.

[115] Dandeliya, S., Khan, S., Srivastava, A.(2016). Ni-Cnt As Isopropanol Sensor: Ab-Initio Analysis, 2016 Ieee International Symposium On Nanoelectronic And Information System. Ieee, Kasım, 2016.

[116] Shengxue, Y., Chengbao, J., Su,-H. (2017) .Gas Sensing İn 2d Materials, Appl. Phys. Rev. 4, 021304.

[117] Elektronların Atomik Orbitallere Dağılımı. Erişim: 10 Eylül 2019, Http://Taner.Balikesir.Edu.Tr/Dersler/Genel_Kimya/Atomik_Yapi/Elektronlarin_At omik_Orbitallere_Dagilimi.Html.

[118] Talmacu, M., Bodoki, M.E., Oprean, R. (2016).Global Chemical Reactivity Parameters For Several Chiral Beta-Blockers From The Density Functional Theory Viewpoint, Clujul Med., 89(4), 513–518.

[119] Ding, L.P., Zhang, F.H., Zhu, Y.S., Lu, C., Kuang, X., Shao, P. (2015).. Understanding The Structural Transformation, Stability Of Medium-Sized Neutral And Charged Silicon Clusters, Scientific Reports, 5, 15951.

[120] Kulkarni, B.S., Krishnamurty, S., Pal, S. (2010). Probing Lewis Acidity And Reactivity Of Sn- And Ti-Beta Zeolite Using Industrially Important Moieties: A Periodic Density Functional Study, J.Mol. Catal. A, 329, 36–43.

[121] Modi, C.K., Trivedi, P.M., Chudasama, J.A., Nakum, H.D., Parmar, D.K.. Gupta, S.K., Jha, P.K. (2014). Zeolite-Y Entrapped Bivalent Transition Metal Complexes As Hybrid Nanocatalysts: Density Functional Theory Investigation And Catalytic Aspects, Green Chem. Lett. Rev., 7 278–287.

[122] Hadipour, N.L., Peyghan, A. A., Soleymanabadi H.(2015). Theoretical study on the Al-doped ZnO nanoclusters for CO nhemical sensors, Phys. Chem. C. 119 6398-6404.

[123] Baei, M.T., Kananib, Y., Rezaei, V.J., Soltani, A. (2014). Adsorption Phenomena Of Gas Molecules Upon Ga-Doped Bn Nanotubes: A Dft Study, Appliedsurface Science 295 18–25.

[124] Xu, L., Yang, Y., Li, W., Tao, Y., Sui, Z., Song, S., Yang, J.(2019).Threedimensional macroporous graphene-wrapped zero-valent copper nanoparticles as efficient micro-electrolysis-promoted Fenton-like catalysts for metronidazole removal, Science of The Total Environment 658 219-233.

[125] Legarreta-Mendoza, A., Flores-Holguín, N., Lardizabal-Gutierrez, D. (2019). A proposal based on quantum phenomena for theORR mechanism on nitrogen-doped carbon-based electrocatalysts, International Journal of Hydrogen Energy 44 12374-12380.

EKLER

EK A: Pt katkılı TDKNT üzerindeki NO adsorpsiyonu için input dosyası **EK B:** Pt katkılı TDKNT üzerindeki NO adsorpsiyonu için output dosyası



EK A

```
%nprocshared=20
%mem=100GB
%chk=cnt60-ptnooptfreq.chk
# opt=maxcycle=9000 freq wb97xd/genecp geom=connectivity
scf=(xqc,maxcycle=9000)
```

0 6 С

0	2.07846200	1.15583700	-7.13057100
0	-0.10849400	2.26463700	-7.10199300
0	-2.32914300	1.29088400	-7.04529200
0	-2.13782100	-1.12139000	-7.06010500
0	-0.03349200	-2.30509300	-7.11768400
0	2.16324100	-1.24656900	-7.13712700
0	2.56338500	-0.03635100	-5.02966600
0	2.49304800	-0.03223800	-6.43691500
0	2.25152400	1.36915700	-2.94540100
0	2.12473100	1.19258400	-4.32039800
0	1.11124800	1.91960400	-5.01467100
0	1.09167600	1.92350700	-6.44855200
0	-0.00394500	2.23725400	-2.84860800
0	-0.04247800	2.25381400	-4.27158300
0	-1.29173500	2.08037000	-4.96513200
0	-1.31627500	2.07165300	-6.37860600
0	-2.22895200	1.25954300	-2.84973500
0	-2.24223200	1.25739700	-4.22467900
0	-2.52669300	0.02592600	-4.94814100
0	-2.54737800	0.03454000	-6.36452600
0	-2.04745700	-1.13255600	-2.83108800
0	-2.07897700	-1.13626900	-4.25598100
0	-1.19773300	-1.98899600	-4.97231900
0	-1.22549600	-1.98152100	-6.39790400
0	0.06998400	-2.29020200	-2.85685800
0	0.02427000	-2.310/0500	-4.2/580100
0	1.19216600	-2.02846400	-5.02363200
0	1.1/24/200	-2.02077800	-6.46012000
0	2.33524100	-1.48090400	-2.95133500
0	2.19805500	-1.299/3100	-4.32/08/00
0	2.09014000	-0.02001900	-0.30010000
0	2.00/3/000	1.14030300	1.40125000
0	2.10072300	1.14914100	-0 72581300
0	1 21893100	1.95138500	-0.72501500 -2.16652400
0	-0 01188800	2 28941000	1 40769500
0	0.01100000	2 24618400	-0 03493000
0	-1 21638100	2 07755500	-0 74644100
0	-1.23178200	2.06540400	-2.12428000
0	-2.19042200	1.25685200	1.36783900
0	-2.19471500	1.26034400	-0.00585300
0	-2.46069200	0.01819500	-0.72751400
0	-2.48319700	0.01785800	-2.12149800
0	-2.02950600	-1.13597500	1.40025100
0	-2.01426100	-1.13520700	-0.02502000

С	0	-1.10992700	-1.97702200	-0.73170800
С	0	-1.12384300	-1.96612000	-2.13707500
С	0	0.05478300	-2.33870300	1.41563400
С	0	0.10268700	-2.30184000	-0.02179300
С	0	1.30945000	-2.05767000	-0.71987200
С	0	1.30688800	-2.07359700	-2.16790800
С	0	2.16873400	-1.25092800	1.48198300
С	0	2.24421400	-1.25346800	0.07318700
С	0	2.37975000	-0.03302400	3.63418200
С	0	2.42570200	-0.03527600	2.20160300
С	0	2.01735300	1.15994700	4.30033200
С	0	1.12012500	2.01077900	3.58677000
С	0	1.15297800	1.99699200	2.15726800
С	0	-0.08988500	2.35157600	4.23440100
С	0	-1.27998600	2.10862600	3.51601400
С	0	-1.24557900	2.09957700	2.09585000
С	0	-2.26839500	1.29667200	4.19007700
С	0	-2.46082300	0.03596600	3.51890300
С	0	-2.44697300	0.02648500	2.09365100
C	0	-2.08418600	-1.13082500	4.20675700
С	0	-1.19158200	-2.01745300	3.53677800
С	0	-1.15692300	-2.01321400	2.10883600
С	0	-0.01769700	-2.38091100	4.24963900
С	0	1.19873500	-2.10214700	3.59712100
С	0	1.23051400	-2.09788000	2.16527700
С	0	2.11847400	-1.26208800	4.30590800
Н	-1	-2.37017300	1.30872100	-8.13110200
Н	-1	-0.14053800	2.22677600	-8.18764800
Н	-1	-2.11392400	-1.09031300	-8.14638400
Н	-1	2.05818800	1.13886100	-8.21687600
Н	-1	-0.06050400	-2.27094500	-8.20347400
Н	-1	2.14880100	-1.22877100	-8.22346300
Н	-1	2.08184800	-1.26142300	5.39187100
Н	-1	-0.04353700	-2.34221600	5.33536300
Н	-1	1.96278800	1.15222100	5.38560700
Н	-1	-2.06089600	-1.10941600	5.29322000
Н	-1	-0.12249300	2.31222500	5.31999500
Н	-1	-2.30751700	1.32164700	5.27574200
Pt	0	3.51278000	-0.01924800	-2.21227500
N	0	5.06834868	-0.05512655	-1.96700605
0	0	6.16332489	-0.09828637	-1.59049361

Pt O lanl2dz **** C H N O 06-31g(d,p) **** Pt O lanl2dz

0

С

66

•

EK B

SLURM_NODELIST barbun141 Entering Gaussian System, Link 0=/truba/home/demirs/BTU_G-09/g09/g09 Initial command: /truba/home/demirs/BTU_G-09/g09/l1.exe "/tmp/Gau-325133.inp" scrdir="/tmp/" Entering Link 1 = /truba/home/demirs/BTU_G-09/g09/l1.exe PID= 325134. Copyright (c) 1988,1990,1992,1993,1995,1998,2003,2009,2013, Gaussian, Inc. All Rights Reserved. This is part of the Gaussian(R) 09 program. It is based on

the Gaussian(R) 03 system (copyright 2003, Gaussian, Inc.), the Gaussian(R) 98 system (copyright 1998, Gaussian, Inc.), the Gaussian(R) 94 system (copyright 1995, Gaussian, Inc.), the Gaussian 92(TM) system (copyright 1992, Gaussian, Inc.), the Gaussian 90(TM) system (copyright 1990, Gaussian, Inc.), the Gaussian 88(TM) system (copyright 1988, Gaussian, Inc.), the Gaussian 86(TM) system (copyright 1986, Carnegie Mellon University), and the Gaussian 82(TM) system (copyright 1983, Carnegie Mellon University). Gaussian is a federally registered trademark of Gaussian, Inc.

This software contains proprietary and confidential information, including trade secrets, belonging to Gaussian, Inc.

This software is provided under written license and may be used, copied, transmitted, or stored only in accord with that written license.

The following legend is applicable only to US Government contracts under FAR:

RESTRICTED RIGHTS LEGEND

Use, reproduction and disclosure by the US Government is subject to restrictions as set forth in subparagraphs (a) and (c) of the Commercial Computer Software - Restricted Rights clause in FAR 52.227-19.

Gaussian, Inc. 340 Quinnipiac St., Bldg. 40, Wallingford CT 06492

Warning -- This program may not be used in any manner that competes with the business of Gaussian, Inc. or will provide assistance to any competitor of Gaussian, Inc. The licensee of this program is prohibited from giving any competitor of Gaussian, Inc. access to this program. By using this program, the user acknowledges that Gaussian, Inc. is engaged in the business of creating and licensing software in the field of computational chemistry and represents and warrants to the licensee that it is not a competitor of Gaussian, Inc. and that it will not use this program in any manner prohibited above.

```
Cite this work as:
 Gaussian 09, Revision D.01,
M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria,
M. A. Robb, J. R. Cheeseman, G. Scalmani, V. Barone, B.
Mennucci,
 G. A. Petersson, H. Nakatsuji, M. Caricato, X. Li, H. P.
Hratchian,
 A. F. Izmaylov, J. Bloino, G. Zheng, J. L. Sonnenberg, M. Hada,
M. Ehara, K. Toyota, R. Fukuda, J. Hasegawa, M. Ishida, T.
Nakajima,
Y. Honda, O. Kitao, H. Nakai, T. Vreven, J. A. Montgomery, Jr.,
 J. E. Peralta, F. Ogliaro, M. Bearpark, J. J. Heyd, E. Brothers,
K. N. Kudin, V. N. Staroverov, T. Keith, R. Kobayashi, J.
Normand,
K. Raghavachari, A. Rendell, J. C. Burant, S. S. Iyengar, J.
Tomasi,
M. Cossi, N. Rega, J. M. Millam, M. Klene, J. E. Knox, J. B.
Cross,
V. Bakken, C. Adamo, J. Jaramillo, R. Gomperts, R. E. Stratmann,
 O. Yazyev, A. J. Austin, R. Cammi, C. Pomelli, J. W. Ochterski,
 R. L. Martin, K. Morokuma, V. G. Zakrzewski, G. A. Voth,
 P. Salvador, J. J. Dannenberg, S. Dapprich, A. D. Daniels,
 O. Farkas, J. B. Foresman, J. V. Ortiz, J. Cioslowski,
 and D. J. Fox, Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2013.
 Gaussian 09: ES64L-G09RevD.01 24-Apr-2013
             10-Jun-2019
 ************
 %nprocshared=20
Will use up to
               20 processors via shared memory.
 %mem=100GB
 %chk=cnt60-ptnooptfreq.chk
 _____
 # opt=maxcycle=6000 freq wb97xd/genecp geom=connectivity
scf=(xqc,maxc
ycle=6000)
 _____
 1/6=6000,14=-1,18=20,19=15,26=3,38=1,57=2/1,3;
 2/9=110, 12=2, 17=6, 18=5, 40=1/2;
 3/5=7,11=2,16=1,17=8,25=1,30=1,71=1,74=-58/1,2,3;
 4//1;
 5/5=2,7=6000,8=3,13=1,38=5/2,8;
 6/7=2,8=2,9=2,10=2,28=1/1;
 7//1,2,3,16;
 1/6=6000,14=-1,18=20,19=15,26=3/3(2);
 2/9=110/2;
 99//99;
 2/9=110/2;
 3/5=7,6=1,11=2,16=1,17=8,25=1,30=1,71=1,74=-58,82=7/1,2,3;
 4/5=5,16=3,69=1/1;
 5/5=2,7=6000,8=3,13=1,38=5/2,8;
 7//1,2,3,16;
```

```
1/6=6000,14=-1,18=20,19=15,26=3/3(-5);
  2/9=110/2;
  6/7=2,8=2,9=2,10=2,19=2,28=1/1;
  99/9=1/99;
  ____
  *****
  ____
  Symbolic Z-matrix:
  Charge = 0 Multiplicity = 6
  С
                       0
                            2.07846 1.15584 -7.13057
  С
                       0
                            -0.10849 2.26464 -7.10199
  С
                            -2.32914
                                      1.29088 -7.04529
                       0
  С
                       0
                            -2.13782 -1.12139 -7.06011
                                                  0.449238
 Zero-point correction=
(Hartree/Particle)
  Thermal correction to Energy=
                                                   0.484709
  Thermal correction to Enthalpy=
                                                   0.485654
  Thermal correction to Gibbs Free Energy=
                                                   0.387291
  Sum of electronic and zero-point Energies=
                                                      -2959.886119
  Sum of electronic and thermal Energies=
                                                      -2959.850648
  Sum of electronic and thermal Enthalpies=
                                                      -2959.849704
  Sum of electronic and thermal Free Energies=
                                                      -2959.948066
                      E (Thermal)
                                              CV
                                                                S
                       KCal/Mol
                                      Cal/Mol-Kelvin
                                                         Cal/Mol-
Kelvin
                         304.160
 Total
                                            166.574
 207.021
                           0.000
                                              0.000
 Electronic
 3.561
 Translational
                           0.889
                                              2.981
 46.836
                           0.889
 Rotational
                                              2.981
 39.800
 Vibrational
                        302.382
                                            160.613
 116.825
 Vibration
                           0.593
               1
                                              1.985
 6.445
 Vibration
                2
                          0.593
                                              1.985
 6.163
 Vibration
                3
                          0.597
                                              1.972
 4.338
 Vibration
                4
                          0.598
                                              1.968
 4.142
 Vibration
                5
                          0.604
                                              1.949
 3.454
 Vibration
                6
                          0.608
                                              1.936
 3.162
 Vibration
                7
                          0.609
                                              1.932
 3.087
 Vibration
                8
                          0.615
                                              1.914
 2.812
```

Vibration	9	0.617	1.905
2.699 Vibration	10	0.628	1.871
2.363 Vibration	11	0.629	1.867
2.326 Vibration	12	0.631	1.861
2.282 Vibration	1.3	0.633	1.857
2.249	1 /	0.634	1 951
2.210	1 -	0.034	1 004
2.096	15	0.640	1.834
Vibration 1.859	16	0.653	1.791
Vibration 1.681	17	0.667	1.751
Vibration 1.631	18	0.671	1.738
Vibration	19	0.672	1.734
Vibration	20	0.675	1.726
Vibration	21	0.681	1.707
Vibration	22	0.687	1.689
1.465 Vibration	23	0.697	1.660
1.378 Vibration	24	0.700	1.651
1.353 Vibration	25	0.717	1.603
1.229 Vibration	26	0.719	1.597
1.216 Vibration	27	0 723	1 586
1.191	27	0.720	1 571
vibration 1.156	28	0.729	1.5/1
Vibration 1.145	29	0.731	1.565
Vibration 1.107	30	0.737	1.547
Vibration 1.074	31	0.743	1.531
Vibration	32	0.748	1.518
Vibration	33	0.753	1.504
Vibration	34	0.762	1.479
0.979 Vibration	35	0.770	1.459
0.944 Vibration	36	0.771	1.456
0.939 Vibration	37	0.773	1.453
0.933			

Vibration	38	0.777	1.442
Vibration	39	0.786	1.418
0.879 Vibration	40	0.788	1.413
0.872			
Vibration 0.864	41	0.790	1.409
Vibration	42	0.798	1.387
Vibration	43	0.803	1.376
0.816 Vibration	44	0.809	1.360
0.794 Wibration	45	0 013	1 350
0.781	40	0.013	1.330
Vibration 0.761	46	0.819	1.335
Vibration	47	0.822	1.330
0.754 Vibration	48	0 827	1 316
0.737	10	0.027	1.010
Vibration	49	0.833	1.303
Vibration	50	0.842	1.280
0.693 Vibration	51	0.844	1.276
0.688			
Vibration 0 673	52	0.850	1.263
Vibration	53	0.853	1.255
0.664 Vibration	54	0.866	1.225
0.631 Wibration	5 5	0 990	1 105
0.598	55	0.000	1.195
Vibration 0 560	56	0.898	1.156
Vibration	57	0.916	1.117
0.523 Vibration	58	0.922	1.105
0.512 Vibration	59	0.924	1.101
0.509		0.007	1 0 0 5
Vibration 0.503	60	0.927	1.095
Vibration	61	0.936	1.075
Vibration	62	0.938	1.073
0.484 Vibration	63	0.943	1.061
0.474	C A	0.045	1 050
0.471	04	0.740	T.030
Vibration	65	0.949	1.051
Vibration	66	0.950	1.048
0.403			

Vibration 0.450	67	0.958	1.032
Vibration	68	0.966	1.017
Vibration	69	0.966	1.016
Vibration	70	0.970	1.008
Vibration	71	0.975	0.999
Vibration 0.417	72	0.980	0.990

	Ttem	Value	Threshold	Converged?
Maximum	Force	0.000031	0.000450	YES
RMS	Force	0.000006	0.000300	YES
Maximum	Displacement	0.036719	0.001800	NO
RMS	Displacement	0.001500	0.001200	NO
Predicted change in Energy=-4.443039D-07				

 ${\tt Grad} {$

•

1\1\GINC-BARBUN141\Freq\UwB97XD\GenECP\C71H12N101Pt1(6)\DEMIRS\11-Jun-2019\0\\#N Geom=AllCheck Guess=TCheck SCRF=Check GenChk UwB97XD/GenECP Freq****\\0,6\C,2.0702696483,1.1705981113,-7.1317704494\C,-0.10027 20157,2.2910015772,-7.1067093191\C,-2.2945117554,1.2633429523,-7.04699 29024\C,-2.1686703312,-1.1425098333,-7.0668047855\C,-0.0478150812,-2.2 992438866,-7.1153990565\C,2.1420216649,-1.2268128291,-7.1321872467\C,2 .533970114,-0.0030979644,-5.02791785\C,2.477885139,-0.010826997,-6.432 1598984\C,2.2664284604,1.3573833577,-2.922186887\C,2.1187287251,1.2190 734386,-4.3138080601\C,1.133101988,1.9652363127,-5.0151029271\C,1.1076 489205,1.9646557645,-6.4509465965\C,0.0079354638,2.2673726909,-2.85485 23862\C,-0.0342951294,2.2945328944,-4.2739548464\C,-1.2581758167,2.032 5295015,-4.9604981494\C,-1.296441769,2.0425784919,-6.3911926512\C,-2.1 534249758,1.1979404517,-2.8392548548\C,-2.1815434662,1.2081407823,-4.2 43349582\C,-2.5405099305,0.0091706182,-4.9542654384\C,-2.5614636013,0. 0240459278,-6.3736548788\C,-2.1241220877,-1.175953011,-2.8415135443\C, -2.1431502592,-1.1741439701,-4.2613046178\C,-1.2368883394,-2.012475812

```
5,-4.9786051256\C,-1.2514478566,-1.9972671164,-
6.405255248\C,0.0213067
 628, -2.27133632, -2.8564989185\C, -0.0153083819, -2.2941810588, -
4.2773439
22\C,1.1553266433,-1.979434566,-5.0084317021\C,1.1486685269,-
1,9941670
454,-6.448615592\C,2.2739654311,-1.3636987962,-
2.9179934386\C,2.146270
0523,-1.2372063889,-4.301989951\C,2.6398258733,-0.0119779165,-
0.556879
8978\c,2.0799210005,1.1660283046,1.4743170895\c,2.1561029728,1.16819
90
14,0.0508623889\C,1.2386961561,1.9904228362,-
0.7325103061\C,1.24265405
 9,2.0006807903,-2.172359543\C,-
0.0010370569,2.3286928603,1.4064615075
 C, 0.0387715259, 2.2935532676, -0.0315711393\C, -
1.1751189314,2.0125580006
 ,-0.7333630984\C,-1.1922960504,2.0014863436,-2.1429759669\C,-
2.1206533
416,1.206262415,1.3852137716\C,-2.1127919877,1.1983326398,-
0.019994227
 4\C,-2.4708608503,-0.0017500449,-0.7223816951\C,-2.5000918118,-
0.00117
 53808,-2.1292222699\C,-2.0873943144,-1.1742217017,1.4023247961\C,-
2.08
 70460168, -1.1801365817, -0.0173936597\C, -1.1722069026, -
2.0144090118,-0.
 732977132\C,-1.1852570488,-1.9986082431,-
2.1402303746\C,0.0131069069,-
 2.3396844326,1.4126960071\C,0.047235626,-2.30626953,-
0.0278151628\C,1.
 2431685993, -2.0147688432, -0.7262223507\C, 1.2477775044, -
2.0078673087,-2
 .1694070226\C,2.1078894945,-
1.2077025134,1.4685628635\C,2.1743843204,-
1.2051682269,0.0567743752\C,2.3758741891,-
0.0188238945,3.626955995\C,2
 .4151523871,-
0.0144014684,2.1966761535\C,2.0190439812,1.171476132,4.30
08524213\c,1.1337676473,2.0335054696,3.5895778582\c,1.1718796648,2.0
32
0781479,2.1583101441\C,-0.0812255765,2.3723588703,4.2384391281\C,-
1.25
 98865134,2.0864166726,3.5249759131\C,-
1.2164597143,2.0669040188,2.0929
735257\C,-2.2317735016,1.2698793645,4.1917375562\C,-
2.4607677335,0.025
 6053059,3.528547465\C,-2.4466800714,0.0105566814,2.0956568302\C,-
2.112
 2856086,-1.1523281763,4.2133152853\C,-1.216221632,-
2.0370914324,3.5434
 919832\C,-1.1956257709,-2.0423869875,2.1127793416\C,-0.0355029614,-
2.3
 824210851,4.2496518733\C,1.1726828226,-
2.0785158233,3.5892749418\C,1.1
 915637829,-2.067375977,2.1545706644\C,2.0901127873,-
1.2417698268,4.300
```

```
5482758\H,-2.370173,1.308721,-8.131102\H,-0.140538,2.226776,-
8.187648\
H,-2.113924,-1.090313,-8.146384\H,2.058188,1.138861,-8.216876\H,-
0.060
504, -2.270945, -8.203474\H, 2.148801, -1.228771, -8.223463\H, 2.081848, -
1.2
61423,5.391871\H,-0.043537,-
2.342216,5.335363\H,1.962788,1.152221,5.38
5607\H,-2.060896,-1.109416,5.29322\H,-
0.122493,2.312225,5.319995\H,-2.
307517,1.321647,5.275742\Pt,3.6674803699,0.0050728079,-
2.1887667613\N,
5.542279454,-0.0947973562,-2.1351525576\0,6.698146658,-
0.1759165776,-1
 .8941098388\\Version=ES64L-G09RevD.01\State=6-A\HF=-
2960.3353573\S2=9.
 542319\S2-1=0.\S2A=9.021326\RMSD=3.694e-09\RMSF=1.715e-
05\ZeroPoint=0.
 4492385\Thermal=0.4847095\Dipole=-
2.6151822,0.1011324,0.5986928\Dipole
Deriv=-0.3584743,-0.1687545,0.1856232,-0.2253065,-
0.0434688,0.3548856,
0.0031194,-0.0654762,0.1774273,-0.2384625,-0.1228543,-
0.0046808,0.0028
267,-0.2993789,0.2248277,0.0462594,-0.1085782,0.1941063,-
0.5164984,0.1
 650409,-0.1849443,0.344186,0.0867089,0.274622,0.0591482,-
0.1540062,0.2
 679585,-0.25477,-0.1505432,-0.2841409,-0.1819712,0.0456735,-
0.3532165.
0.1297805, 0.1284204, 0.1734714, -0.0731846, 0.1493647, -0.0626671, -
0.10941
36,-0.3272699,-0.2543107,-0.0217221,0.1140586,0.195626,-
0.2683589,0.17
66369,0.0790365,0.1824117,-0.0800368,-0.3195531,-
0.1047947,0.0836763,0
 .3212149,-0.2730637,0.0007672,-
0.2381847,0.0908591,0.1565869,0.0271214
 ,0.1876954,-0.0241703,0.1298897,-
0.0118245,0.002541,0.0483902,0.053043
3,0.1114551,-0.0018106,-0.0256636,0.0264846,-0.1642819,0.2229375,-
0.02
22428,0.1200743,0.2293718,-
0.0990405,0.0514281,0.3907311,0.1873627,0.4
 618652, -0.2476351, 0.0364751, 0.0013955, -0.1904801, -
0.0883339,0.1145829,
-0.4707757,-0.0697312,-0.4128972,0.3360516,-0.0214324,0.2015665,-
0.012
 3553,-0.0276784,-0.0238435,-0.1382612,-
0.0936922,0.1560152,0.3561032,0
 .0036661,0.0630908,-0.0491484,0.0139747,-
0.1300603,0.0723482,0.1077585
 ,-0.2254979,-0.3357492,-0.1131642,-0.0908944,-0.0449365,-
0.0657625,-0.
0660777,0.1390512,-0.0023585,0.0514306,-0.2253962,-0.1603808,-
0.014246
7,0.0313377,-0.0266088,-0.135391,-0.009026,-0.0015863,-
0.1816286,0.276
06,0.2137003,-0.2189611,0.0303859,-
0.0702503,0.1314637,0.2616008,0.112
```

```
3168,0.1473367,0.46279,0.1098682,-0.1513462,0.0564308,0.0033805,-
 0.061
  0396,-0.3025148,-0.0726611,-0.1773096,-
 0.0420787,0.0526704,0.0344517,0
  .2831282,0.2475213,0.0037195,-0.2590251,-0.3507774,0.2450804,-
 0.012461
 1,0.0284514,0.07635,0.2483419,0.1899201,0.1381948,0.2531091,0.313274
 6,
  -0.259902,-0.3197044,0.0168973,0.0806912,-0.1079551,-
 0.1974299,0.02314
  94,-0.1918644,-0.0132247,0.1253,0.0325033,0.0314864,0.119217,-
 0.137082
  ,-0.0666727,0.0131426,0.0648035,0.0193642,-0.2903414,0.0192081,-
 0.0296
  557,-0.0938219,-
 0.1131846,0.1510885,0.001856,0.0637341,0.3192035,0.308
  3806,0.0729634,-0.0147865,0.0632185,-0.0967902,0.1105667,-
 0.1688447, -0
  .0466678,-0.2800552,-0.2265357,0.1335263,-0.2330523,-0.1634496,-
0.0367
  932, -0.0480691, 0.0229155, 0.1821174, -0.1082832, 0.25458, 0.249792, -
 0.1777
  117, -0.0652199, -0.0474907, 0.053163, 0.1355867, -0.1933648, 0.0686499, -
 03
  659004,-0.1182955,0.0975129,0.0117954,-0.0365238,-
 0.0728891,0.0883894,
  0.0678114,-0.0191445,0.0711721,-0.0606871,0.1455331,0.0581716,-
 0.06667
  14,-0.0357532,0.0395548,0.0267198,0.0367296,-
 0.1393329,0.1550932,0.062
  9215,0.2267429,0.0336574,-0.0029899,0.0372244,-
 0.0551352,0.1286151,0.2
  005505,0.1563993,-
 0.0295118,0.1322414,0.0687599,0.0280243,0.1095997,0.
  0148802,-0.156461,-0.2069012,0.1368284,0.043563,-0.0185727,-
 0.2459863,
  -0.1000475,0.0151078,0.0769985,-0.0821126,0.4265839,-0.2045174,-
 0.0576
  237,-0.1108975,0.0445134,-0.099122,-0.2406993,-0.2014719,-
 0.012522,-0.
  4960206,0.2486645,0.0082244,-
 0.361749,0.1098558,0.2301932,0.2468947,-0
  "PERFECTION IS NOT AN ACCIDENT"
           -- EAGLE ELECTRIC MANUFACTURING CO., INC. NY
  Job cpu time:
                        6 days 15 hours 36 minutes 33.7 seconds.
  File lengths (MBytes): RWF= 34114 Int=
                                                     0 D2E=
 Chk =
          128 Scr=
                         1
  Normal termination of Gaussian 09 at Tue Jun 11 12:04:59
```

```
2019.
```

ÖZGEÇMİŞ



Ad-Soyad	:Selin DEMİR
Doğum Tarihi ve Yeri	:1993 / Osmangazi
E-posta	:selindemir1693@gmail.com

ÖĞRENİM DURUMU:

- Lisans :2016, Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği
- Yüksek Lisans :2019, Bursa Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

MESLEKİ DENEYİM VE ÖDÜLLER:

• Laboratuvar mühendisi, Polyteks, 2017-2018

DİĞER ESERLER, SUNUMLAR VE PATENTLER:

• Bilimsel Araştırma Makalesi, A DFT study on Pt doped (4,0) SWCNT: CO adsorption and sensing, Selin Demir, Mehmet Ferdi Fellah, Applied Surface Science (doi: 10.1016/j.apsusc.2019.144141)